

**ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К ЖУРНАЛУ
«ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ»
Том 29 за 1995 г.**

	Стр.
1. Электромагнетизм, оптика, акустика (PACS 40).	2278
1.1. Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55.Px).	2278
2. Структура, механические и термические свойства (PACS 60).	2278
2.1. Структура, кристаллография (PACS 61).	2278
2.1.1. Исследование структуры полупроводников (PACS 61.10-61.16).	2278
2.1.2. Аморфные, стеклообразные полупроводники (PACS 61.43).	2279
2.1.3. Кластеры и наночастицы (PACS 61.46).	2279
2.1.4. Дефекты в кристаллах (PACS 61.72).	2281
2.1.5. Физические эффекты, связанные с облучением. Радиационные дефекты (PACS 61.80).	2282
2.2. Механические и акустические свойства (PACS 62).	2282
2.3. Динамика решеток (PACS 63).	2283
2.4. Фазовые равновесия и фазовые переходы (PACS 64).	2283
2.5. Термические свойства (PACS 65).	2283
2.6. Диффузия (PACS 66).	2283
2.7. Структура поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 68).	2284
3. Электронная структура, электрические, магнитные и оптические свойства (PACS 70).	2285
3.1. Электронные состояния (PACS 71).	2285
3.1.1. Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55).	2285
3.2. Транспортные явления (PACS 72).	2287
3.2.1. Явления электронной проводимости в полупроводниках (PACS 72.20).	2288
3.2.2. Фотопроводимость и фотовольтаический эффект (PACS 72.40).	2289
3.3. Электронная структура и электрические свойства поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 73).	2290
3.3.1. Электронные состояния на поверхностях и границах раздела (PACS 73.20).	2291
3.3.2. Барьеры Шоттки (PACS 73.30).	2292
3.3.3. Транспортные явления в структурах, содержащих границы раздела (PACS 73.40).	2293
3.3.4. Транспортные явления в тонких пленках (PACS 73.50).	2296
3.4. Магнитные свойства (PACS 75), магнитные резонансы (PACS 76).	2296

3.5.	Оптические свойства полупроводников, спектроскопия, взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78).	2297
3.5.1.	Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20).	2297
3.5.2.	Инфракрасная спектроскопия, комбинационное рассеяние (PACS 78.30).	2297
3.5.3.	Люминесценция, излучательная рекомбинация (PACS 78.55; 78.60).	2298
3.5.4.	Оптические свойства тонких пленок, поверхностей и структур, содержащих границы раздела (сверхрешетки, гетеропереходы и т.п.) (PACS 78.66).	2300
3.6.	Эмиссия электронов и ионов. Ударная ионизация (PACS 79).	2301
4.	Технология, материаловедение, применение полупроводников (PACS 80).	2302
4.1.	Методы получения и обработки полупроводниковых материалов (PACS 81).	2302
4.2.	Полупроводниковые приборы (PACS 85).	2303
5.	Обзоры.	2304
6.	Персоналии.	2304

1. Электромагнетизм, оптика, акустика (PACS 40)

Влияние однородного высокочастотного поля на форму электромагнитной волны в квантовой сверхрешетке. Ф.Г. Басс, С.В. Крючков, А.И. Шаповалова			1,	19
Особенности нелинейного отражения электромагнитных волн от многослойной структуры, связанные с разогревом электронного газа в легированном слое n-GaAs. А.И. Воронко, С.Е. Куменков, Г.Н. Шкерлин			11,	2024

1.1. Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55.Px)

Поляризация сверхлюминесценции и анизотропия оптических потерь в волноводной структуре InGaP/GaAs/InGaP. В.Я. Алешкин, С.А. Атлестина, Б.Н. Звонков, Н.В. Звонков, Е.Р. Линькова, И.Г. Малкина, Ю.Н. Сафьянов, Д.Г. Ревин			4,	590
Поляризация излучения лазеров на основе двойной гетероструктуры InAsSb/InAsSbP. Т.Н. Данилова, О.Г. Ершов, Г.Г. Зебря, А.Н. Именков, М.В. Степанов, В.В. Шерстнев, Ю.П. Яковлев			9,	1604
Особенности температурной зависимости пороговой плотности тока ДГС лазеров на основе GaInAsSb с тонкой активной областью. Г.Г. Зебря, Н.А. Гунько, Е.В. Фролушкина, А.Н. Именков, Ю.П. Яковлев			12,	2208

2. Структура, механические и термические свойства (PACS 60)

2.1. Структура, кристаллография (PACS 61)

2.1.1. Исследование структуры полупроводников (PACS 61.10-61.16)

Люминесцентные и структурные исследования монокристаллов GaSb, выращенных из нестехиометрических расплавов. Н.А. Берт, А.Е. Куницын, А.Г. Мильвидская, М.Г. Мильвидский, В.В. Чалдышев			5-6,	1116
Стимулированная лазером газофазная эпитаксия ZnSe на GaAs. А.В. Коваленко, А.Ю. Мекекечко			8,	1461
Исследование электрофизических свойств пленок α-C:H, перспективных для защитных покрытий электрофотографических носителей информации. В.Х. Кудоярова, В.Л. Аверьянов, А.В. Чернышев, М.Б. Цолов			9,	1662

Кислород в люминесценции ZnSe(Te). Н.К. Морозова, Л.Д. Назарова, И.А. Каретников, В.Г. Галстян, Л.П. Гальчинецкий, В.Д. Рыжиков, О.Р. Голованова	9,	1678
Квантовые точки InAs/GaAs, полученные методом субмонослойной миграционно-стимулированной эпитаксии. Г.Э. Цырлин, А.О. Голубок, С.Я. Тупицев, Н.Н. Леденцов	9,	1697
Особенности структурного совершенства кристаллов SiC-6H, выращенных модифицированным методом Лели. А.Н. Андреев, А.С. Трегубова, М.П. Шеглов, В.П. Растегаев, С.И. Дорожжкин, В.Е. Челноков	10,	1828
Наблюдение атомарной структуры пассивированной в водородной ЭЦР плазме поверхности Si (111) с помощью сканирующего туннельного микроскопа на воздухе. В.Л. Гуртовой, В.В. Дремов, В.А. Макаренко, С.Ю. Шаповал	10,	1888
Пространственное упорядочение кластеров мышьяка в слоях GaAs, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии при низкой температуре. Н.А. Берт, В.В. Чалдышев, Д.И. Лубышев, В.В. Преображенский, Б.Р. Семягин	12,	2232
2.1.2. Аморфные, стеклообразные полупроводники (PACS 61.43)		
К вопросу о вольт-амперной характеристике гетероструктуры на основе неупорядоченного селенида цинка. А.П. Беляев	1,	70
Получение методом сублимации легированных пленок поликристаллического кремния. Д.А. Павлов, В.Г. Шенгуров, Д.В. Шенгуров, А.Ф. Холлов	2,	286
Влияние имплантации Si ⁺ на свойства аморфного гидрированного кремния. О.А. Голикова, Х.Ю. Маевлянов, И.Н. Петров, Р.Р. Яфаев	4,	577
Структурная сетка и уровень Ферми псевдолегированного аморфного гидрированного кремния. О.А. Голикова, В.Х. Кудоярова	5-6,	1128
Электрофотографическая спектроскопия глубоких уровней в As ₂ Se ₃ и As ₂ S ₃ . А.М. Андриеш, С.А. Малков, В.И. Верлан	7,	1319
Исследование силикатных стекол, легированных микрокристаллами сульфида-селенида кадмия, и оптических волноводов на их основе. С.Г. Конников, А.А. Липовский, Н.В. Никоноров, А.А. Ситникова, М.В. Харченко	8,	1473
О встраивании азота в сетку аморфного гидрированного кремния. Н.С. Жданович	8,	1502
О фотолюминесценции пленок α-Si:H, легированных редкоземельными элементами. Ж. Атаев, В.А. Васильев, И.В. Елизаров, М.М. Мездрогина	9,	1537
Исследование электрофизических свойств пленок α-C:H, перспективных для защитных покрытий электрофотографических носителей информации. В.Х. Кудоярова, В.Л. Аверьянов, А.В. Чернышев, М.Б. Цолов	9,	1662
2.1.3. Кластеры и наночастицы (PACS 61.46)		
Низкотемпературная диффузия кислорода и образование термодоноров в кремнии, легированном изовалентной примесью германия. В.М. Бабич, Н.П. Баран, К.И. Зотов, В.Л. Кирица, В.В. Ковальчук	1,	58
Влияние флуктуаций состава на кинетику дислокаций в пленках твердых растворов полупроводников. В.В. Петузов	1,	104
Особенности деградации полужолирующего арсенида галлия при термообработках. И.Ф. Айбазов, С.В. Мизрин, Б.Е. Саморуков	1,	162
Механизмы геттерирования кислорода в пластинах кремния с неоднородным распределением механических напряжений. Б.Н. Романюк, В.Г. Попов, В.Г. Литовченко, А. Мисиук, А.А. Естуз, Н.И. Кляй, В.П. Мельник	1,	166

Эпитаксиальный рост высококачественного GaAs методом МОС-гидридного осаждения с использованием криофильтрационной очистки арсина. В.В. Валеев, В.Л. Гуртовой, С.Ю. Шапова, В.А. Куреев, Н.В. Смирнов	1,	175
Амфотерное поведение висмута в пленках селенида свинца. В.А. Зыков, Т.А. Гаерикова, С.А. Немов	2,	309
Зависимость характерных размеров крупномасштабных скоплений электрически активных дефектов от их положения вдоль продольной оси монокристаллического слитка InP:Fe. В.А. Юрьев, В.П. Калинушкин	2,	316
Трансформация системы дефектов по толщине пластины CdTe при диффузионном легировании галлием. В.Н. Бабенцов, А.И. Власенко, Н.И. Тарбаев	2,	328
Излучательная рекомбинация в монокристаллах селенида цинка, активированных кислородом. Ю.Ф. Ваксман	2,	346
Емкостная спектроскопия карбида кремния, легированного бором. В.С. Балландович, Е.Н. Мохтов	2,	370
Визуализация крупномасштабных скоплений электрически активных дефектов в монокристаллах фосфида индия и арсенида галлия. В.А. Юрьев, В.П. Калинушкин, О.В. Астафьев	3,	455
Влияние марганца на диффузионное распределение никеля в кремнии. Г.С. Куликов, Ю.А. Чичикалюк, Ш.А. Юсупова	3,	469
Влияние конкурирующих центров преципитации на распределение имплантируемого азота в Si при формировании захороненных слоев. Г.А. Качурин, И.Е. Тыщенко, С.А. Тийс, А.Е. Плотников	3,	495
О роли дырок в формировании коэффициента заполнения заряженных дислокаций в полупроводниках n-типа проводимости. Ю.В. Шикина, Н.И. Шикина	3,	507
Трансформация радиационных дефектов и их скопление при имплантации ионов В ⁺ в кремнии. И.В. Антонова, С.С. Шаймеев	4,	605
Электрические и люминесцентные свойства монокристаллов n-ZnSe, легированных иттербием. Г.Н. Иванова, В.А. Касиян, Д.Д. Недеогло	4,	621
Особенности проводимости кристаллов Cd _{0.95} Mn _{0.05} Te:Co. П.Н. Букиевский, Ю.П. Гнатенко, А.Х. Рожко	4,	702
Проблемы микроэлектроники (1. Диффузия. 2. Дефектообразование. 3. Деградация). В.И. Соколов	5-6,	842
Крупномасштабные скопления электрически активных дефектов в монокристаллах InP:As и InP:Ga. В.А. Юрьев, В.П. Калинушкин	5-6,	1080
Светоизлучающие структуры Si:Er. Технология и физические свойства. Обзор. Н.А. Соболев	7,	1153
Влияние ростовых нарушений структуры на дефектообразование в кремнии при внешних воздействиях. Л.А. Казакевич, П.Ф. Лугаков	7,	1226
Влияние имплантации ионов Ag ⁺ на рассеяние света монокристаллами нелегированного фосфида индия. В.А. Юрьев, В.П. Калинушкин	7,	1313
Влияние быстродиффундирующих примесей на кинетику генерации термодоноров в кремнии при 300–500°С. М.К. Багадырханов, Ш.И. Аскарлов, Н. Наркулов, С.Н. Сражес, Т.У. Тошбоев	8,	1396
Эффект сегрегации ртути при импульсном лазерном отжиге Cd _z Hg _{1-z} Te. М. Кузьма, М. Поцьяк, Е. Шерегий, В. Кемпник, М. Фарина, Р. Цят	8,	1483
Эволюция примесно-дефектной системы нелегированного CdTe n- и р-типа при комнатной температуре. В.Н. Бабенцов, А.И. Власенко, Н.И. Тарбаев	9,	1563

О стоках для радиационно-введенных вакансий и межузельных атомов в исходных кристаллах кремния. А.И. Баранов, Н.И. Бояркина, А.В. Васильев	9,	1570
Кислород в люминесценции ZnSe(Te). Н.К. Морозова, Л.Д. Назарова, И.А. Каретников, В.Г. Галстян, Л.П. Гальчинецкий, В.Д. Рыжиков, О.Р. Голованова	9,	1678
Рекомбинационные свойства имплантированных ионами I, III и VIII групп и термически отожженных кристаллов $Cd_{1-x}Hg_xTe$. М.И. Ибрагимова, Н.С. Барышев, В.А. Житарев, И.Б. Хайбуллин	10,	1755
Особенности структурного совершенства кристаллов SiC-6H, выращенных модифицированным методом Лели. А.Н. Андреев, А.С. Трегубова, М.П. Шеглов, В.П. Растегаев, С.И. Дорожкин, В.Е. Челноков	10,	1828
Исследование структуры поверхности пористого кремния методом ядерного магнитного резонанса. А.И. Мамыкин, А.Ю. Ильин, В.А. Мошников, Н.Е. Мокроусов, А.А. Мамыкин, А.И. Першин	10,	1874
Анализ спектров фотолюминесценции слоев GaAs, выращенных из Ga-Bi растворов-расплавов. А.Е. Куницын, С.В. Новиков, В.В. Чалдышев, М. Панек, Р. Пашкевич, Б. Пашкевич, М. Тлакзала	11,	2088

2.1.4. Дефекты в кристаллах (PACS 61.72)

Влияние ионного облучения на диффузию золота в кремнии. И.В. Антонова, С.С. Шаймеев	1,	3
Рекомбинация неравновесных носителей в треках тяжелых ионов в Si. В.К. Еремин, И.Н. Ильяшенко, Н.Б. Строкан, Б. Шмидт	1,	79
Отжиг центров зеленой люминесценции сульфида кадмия. Н.С. Богданюк, Г.Е. Давидюк, А.П. Шаварова	2,	201
Влияние γ -облучения на электрические параметры тонких пленок SmS. В.В. Каминский, Л.Н. Васильев, Е.Д. Горнушкина, С.М. Соловьев, Г.А. Сосова, Н.М. Володин	2,	306
Исследование кинетики термостимулированной релаксации объемного заряда в окисле SiO_2 структур металл-окисел-полупроводник, облученных γ -квантами ^{60}Co . Ю.В. Баринев, В.Н. Безбородов, В.В. Емельянов, В.С. Першенков	2,	323
Исследование вакансионных дефектов в монокристаллическом кремнии, облученном при 77 К. Х.А. Абдуллин, Б.Н. Мукашев	2,	335
Центры красной люминесценции в монокристаллах CdS и CdS:Cu и их преобразование при электронном облучении. Н.С. Богданюк, Г.Е. Давидюк, А.П. Шаварова	2,	357
Влияние нейтронного и космического излучения на характеристики полевого транзистора с затвором Шоттки. С.В. Оболенский, Г.П. Павлов	3,	413
Влияние конкурирующих центров преципитации на распределение имплантируемого азота в Si при формировании загороненных слоев. Г.А. Качурин, И.Е. Тыщенко, С.А. Туйс, А.Е. Плаотников	3,	495
К вопросу об образовании дефектов структуры при торможении быстрых ионов в кремнии. А.М. Иванов, И.Н. Ильяшенко, Н.Б. Строкан, Б. Шмидт	3,	543
Процессы образования и отжига радиационных дефектов в p-Si(P,Pt). М.С. Юнусов, А. Ахмадалиев, С.С. Сабиров	4,	665
Дефектообразование в кремнии при протонном облучении. С.Е. Мальзанов	4,	725
Фотоэлектрические свойства сильно компенсированных пленок сульфида свинца, сформированных при помощи радиационных технологий. С.П. Зимин, Р.Ф. Зайкина	4,	729
Влияние ростовых нарушений структуры на дефектообразование в кремнии при внешних воздействиях. Л.А. Казакевич, П.Ф. Лузаков	7,	1226

Деградация фотолюминесценции пористого кремния под действием γ -облучения ^{60}Co . <i>Е.В. Астрова, В.В. Емцев, А.А. Лебедев, Д.И. Полоскин, А.Д. Ременюк, Ю.В. Рудь, В.Е. Харцеев</i>	7,	1301
Стабилизация донорного действия галлия в сплавах $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}$, облученных электронами. <i>Е.П. Скипетров</i>	8,	1416
О стоках для радиационно-введенных вакансий и межузельных атомов в исходных кристаллах кремния. <i>А.И. Баранов, Н.И. Бояркина, А.В. Васильев</i>	9,	1570
Дальняя инфракрасная фотопроводимость кремния, облученного быстрыми нейтронами. <i>В.Г. Голубев, Г.И. Кропотов, А.В. Пачекин, Н.А. Соболев, Е.И. Шек, А.А. Дукин</i>	10,	1878
Распределение изотопов, образованных в арсениде галлия при облучении высокоэнергетичными протонами, дейтронами и ядрами ^3He . <i>В.А. Дидик, В.В. Козловский, Р.Ш. Малкович, Е.А. Скоряткина</i>	11,	2078
Излучательная рекомбинация в германии, облученном реакторными нейтронами. <i>В.А. Быковский, В.П. Доброго, Н.И. Долгих, В.В. Емцев, Е.Е. Халлер</i>	12,	2236

2.1.5. Физические эффекты, связанные с облучением.

Радиационные дефекты (PACS 61.80)

Трехмерные кластерные решетки. <i>В.Н. Богомолов, Т.М. Павлова</i>	5-6,	826
Энергия связи D^- -центра в квантовой точке. <i>М.А. Одноблюдов, А.А. Пахомов</i>	5-6,	1110
Люминесцентные и структурные исследования монокристаллов GaSb , выращенных из нестехиометрических расплавов. <i>Н.А. Берт, А.Е. Куницын, А.Г. Мильвидская, М.Г. Мильвидский, В.В. Чалдышев</i>	5-6,	1116
Люминесцентные свойства квантовых точек InAs на видинальной поверхности $\text{GaAs}(100)$. <i>Н.Н. Леденцов, М.В. Максимов, Г.Э. Цырлин, В.Н. Петров, Г.М. Гурьянов</i>	7,	1295
Деградация фотолюминесценции пористого кремния под действием γ -облучения ^{60}Co . <i>Е.В. Астрова, В.В. Емцев, А.А. Лебедев, Д.И. Полоскин, А.Д. Ременюк, Ю.В. Рудь, В.Е. Харцеев</i>	7,	1301
Исследование силикатных стекол, легированных микрокристаллами сульфида-селенида кадмия, и оптических волноводов на их основе. <i>С.Г. Конников, А.А. Липовский, Н.В. Никоноров, А.А. Ситникова, М.В. Харченко</i>	8,	1473
Самоорганизация квантово-размерных напряженных структур $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ на разориентированных поверхностях $\text{GaAs}(100)$ при субмонослойной молекулярно-пучковой эпитаксии. <i>Г.М. Гурьянов, Г.Э. Цырлин, В.Н. Петров, Ю.В. Самсоненко, В.Б. Губанов, Н.К. Поляков, А.О. Голубок, С.Я. Типусев, Е.П. Мусчятина, Н.Н. Леденцов</i>	9,	1642
Квантовые точки InAs/GaAs , полученные методом субмонослойной миграционно-стимулированной эпитаксии. <i>Г.Э. Цырлин, А.О. Голубок, С.Я. Типусев, Н.Н. Леденцов</i>	9,	1697
О механизме самоформирования наноразмерных структур пористого кремния при бестоковом водном травлении. <i>М.Е. Компан, И.Ю. Шабанов</i>	10,	1859
Пространственное упорядочение кластеров мышьяка в слоях GaAs , выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии при низкой температуре. <i>Н.А. Берт, В.В. Чалдышев, Д.И. Лубышев, В.В. Преображенский, Б.Р. Семягин</i>	12,	2232

2.2. Механические и акустические свойства (PACS 62)

Волна пространственной перезарядки ловушек, сопровождающая изгибные колебания пластины полярного полупроводника. <i>В.В. Сеиридов</i>	1,	96
---	----	----

2.3. Динамика решетчи (PACS 63)

Рассеяние электронов на оптических фононах в двумерных квантовых ямах с независимым захватом электронов и фононов. Ю. Пожела, В. Юцене	3,	459
Фотостимулированное усиление фононов, локализованных в двумерном электронном газе. Э.М. Эпштейн	9,	1585
Магнитофононный резонанс на разогретых электронах в антимониде индия. Р.И. Баширов, Р.Р. Баширов, В.А. Елизаров	10,	1870

2.4. Фазовые равновесия и фазовые переходы (PACS 64)

Энтропия плавления полупроводников. А.Р. Регель, В.М. Глазов	5-6,	780
Жидкие полупроводники с вырожденным электронным газом. В.М. Глазов, В.Б. Кольцов	5-6,	806
Электрические свойства и фазовые переходы в системах $Tm_{1-x}Sm_xS$ и $Tm_{1-x}La_xS$. И.А. Смирнов, В.В. Попов, А.В. Голубков, А.В. Гольцев, Б.М. Буттаев	5-6,	857
Основополагающие работы А.Р. Регеля по жидким полупроводникам и современное состояние вопроса. А.А. Андреев	5-6,	924

2.5. Термические свойства (PACS 65)

Предельная термоэлектрическая добротность полупроводниковых кристаллических материалов. Л.П. Булат, В.С. Загордонец	10,	1743
---	-----	------

2.6. Диффузия (PACS 66)

Влияние ионного облучения на диффузию золота в кремнии. И.В. Антонова, С.С. Шаймеев	1,	3
Явление поверхностной сегрегации основных компонентов твердого раствора $A^{III}B^V$ и сегрегационный приповерхностный гетеропереход в $GaAlAs$. В.Н. Бессолов, М.В. Лебедев, Б.В. Царенков	1,	39
Низкотемпературная диффузия кислорода и образование термодоноров в кремнии, легированном изовалентной примесью германия. В.М. Бабич, Н.П. Баран, К.И. Зотов, В.Л. Кирица, В.Б. Ковальчук	1,	58
Механизмы геттерирования кислорода в пластинах кремния с неоднородным распределением механических напряжений. Б.Н. Романюк, В.Г. Попов, В.Г. Литовченко, А. Мисиук, А.А. Ештуз, Н.И. Кляй, В.П. Мельник	1,	166
Трансформация системы дефектов по толщине пластины $CdTe$ при диффузионном легировании галлием. В.Н. Бабенцов, А.И. Власенко, Н.И. Тарбаев	2,	328
Влияние марганца на диффузионное распределение никеля в кремнии. Г.С. Куликов, Ю.А. Чичикаджук, Ш.А. Юсупова	3,	469
Проблемы микроэлектроники (1. Диффузия. 2. Дефектообразование. 3. Деградация). В.И. Соколов	5-6,	842
Диффузия примеси в полупроводнике в двух состояниях, различающихся коэффициентами диффузии и степенью ионизации примесных атомов. Е.Д. Горнушкина, Р.Ш. Малкович	5-6,	908
Взаимодействие атомной и электронно-дырочной подсистем и роль точечных дефектов при диффузии в полупроводниках. Г.С. Куликов, Р.Ш. Малкович	5-6,	937
Влияние легирования фосфором на диффузию олова в пленках $a-Si$:Н. Г.С. Куликов, К.Х. Ходжаев	5-6,	961
Влияние быстродиффундирующих примесей на кинетику генерации термодоноров в кремнии при 300–500°С. М.К. Багадырзанов, Ш.И. Аскарар, Н. Наркулов, С.Н. Сражесев, Т.У. Тошбоев	8,	1396

Получение и исследование структуры 6H-SiC эпитаксиально-диффузионных p-n-структур. А.А. Лебедев, А.Н. Андреев, А.А. Мальцев, М.Г. Растегаева, Н.С. Савкина, В.Е. Челноков	9,	1635
Переход металл-диэлектрик в сильно легированных p ⁺ -квантовых ямах на поверхности кремния n-типа. Н.Т. Баграев, Е.В. Владимирская, В.Э. Гасумянц, В.И. Кайданов, В.В. Кведер, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, Е.И. Чайкина, А.И. Шалыгин	12,	2133
2.7. Структура поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 68)		
Пассивация поверхности GaAs (100) халькогенидами галлия A ₂ ^{III} B ₃ ^{VI} (110). Б.И. Сысоев, Н.Н. Безрядин, Г.И. Котов, Б.Л. Агапов, В.Д. Стрыгин	1,	24
Явление поверхностной сегрегации основных компонентов твердого раствора A ^{III} B ^V и сегрегационный приповерхностный гетеропереход в GaAlAs. В.Н. Бессолов, М.В. Лебедев, Б.В. Царенков	1,	39
Тонкослойные упругонапряженные гетероструктуры InAs _{1-x-y} Sb _{2x} Bi _y /InSb: расчет некоторых физических параметров. Р.Х. Акчурич, О.В. Акимов	2,	362
Эпитаксиальные p-n-структуры из GaAs на Si-подложках: электрические, фотоэлектрические и электролюминесцентные свойства. В.В. Евстропов, Ю.В. Жилев, Н. Назаров, Ю.Г. Садофьев, А.Н. Топчий, Н.Н. Фалеев, Л.М. Федоров, Ю.М. Шерняков	3,	385
Исследование процесса роста эпитаксиальных слоев SiC при химическом осаждении из пара в системе CH ₃ SiCl ₃ -H ₂ . В.В. Зеленин, В.Г. Соловьев, С.М. Старобинец, С.Г. Конников, В.Е. Челноков	5-6,	1122
Гетероэпитаксиальный рост пленок SiC на основе подложек AlN/Al ₂ O ₃ . А.Н. Кузнецов, А.А. Лебедев, М.Г. Растегаева, Н.А. Розачев, Е.И. Теруков, М.П. Шеглов	8,	1425
Влияние температуры роста на подвижность электронов в транзисторных структурах InAlAs/InGaAs, выращенных на подложках InP методом молекулярно-пучковой эпитаксии. В.М. Устинов, А.Ю. Егоров, А.Е. Жуков, Н.Н. Фалеев, А.Ф. Цапильников, П.С. Копьев	8,	1442
Стимулированная лазером газофазная эпитаксия ZnSe на GaAs. А.В. Коваленко, А.Ю. Мекекечко	8,	1461
Сульфидная пассивация поверхности GaAs: открепление уровня Ферми. В.И. Бедный, Н.В. Байдусь	8,	1488
Самоорганизация квантово-размерных напряженных структур In ₂ Ga _{1-2x} As на разориентированных поверхностях GaAs (100) при субмонослойной молекулярно-пучковой эпитаксии. Г.М. Гурьянов, Г.Э. Цырлин, В.Н. Петров, Ю.Б. Самсоненко, В.В. Губанов, Н.К. Поляков, А.О. Голубок, С.Я. Типисев, Е.П. Мусигина, Н.Н. Леденцов	9,	1642
Квантовые точки InAs/GaAs, полученные методом субмонослойной миграционно-стимулированной эпитаксии. Г.Э. Цырлин, А.О. Голубок, С.Я. Типисев, Н.Н. Леденцов	9,	1697
Молекулярно-пучковая эпитаксия кубического GaN на подложках GaAs (001) с использованием гидразина. В.Г. Антипов, А.С. Зубрилов, А.В. Меркулов, С.А. Никишин, А.А. Ситникова, М.В. Степанов, С.И. Трошков, В.П. Улин, Н.Н. Фалеев	10,	1812
Исследование структуры поверхности пористого кремния методом ядерного магнитного резонанса. А.И. Мамыкин, А.Ю. Ильин, В.А. Мошников, Н.Е. Мокроусов, А.А. Мамыкин, А.И. Першин	10,	1874
Наблюдение атомарной структуры пассивированной в водородной ЭЦР плазме поверхности Si (111) с помощью сканирующего туннельного микроскопа на воздухе. В.Л. Гуртовой, В.В. Дремев, В.А. Макаренко, С.Ю. Шаповал	10,	1888

Формирование структуры ступенчатых слоев диоксида олова, полученных реактивным магнетронным распылением. Р.М. Воццлова, Д.П. Димитров, Н.И. Долотов, А.Р. Кузьмин, А.В. Матин, В.А. Мошников, Ю.М. Таров	11,	1987
3. Электронная структура, электрические, магнитные и оптические свойства (PACS 70)		
Релаксационная поляризация в кристаллах селенида цинка при фотовозбуждении. Ю.А. Загоруйко, В.К. Комарь, В.П. Мизаль, О.Н. Чугай	5-6,	1065
3.1. Электронные состояния (PACS 71)		
Фазовый переход диэлектрик-металл: термодинамический аспект проблемы. Д.Н. Бычковский, О.В. Константинов, В.В. Царенков	1,	152
Симметричная ортогонализация остовных блоховских функций в алмазе. С.В. Сиротюк, Ю.Е. Кинаш	2,	240
Фотолюминесценция монокристаллов $CuAl_xIn_{1-x}S_2$. И.В. Боднарь, Ф.П. Кесаманлы, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь	2,	318
Тонкослойные упругонапряженные гетероструктуры $InAs_{1-x}Sb_xBi_y/InSb$: расчет некоторых физических параметров. Р.Х. Акчурун, О.В. Акимов	2,	362
Определение параметров зонной структуры $CdAs_2$ методами оптического пропускания и фотопроводимости. В.А. Морозова, Т.В. Семененя, С.М. Лосева, О.Г. Кошелев, С.Ф. Маренкин, А.М. Раухман	3,	393
Температурная зависимость ширины запрещенной зоны GaAs. А.Г. Дмитриев	3,	442
Влияние имплантации Si^+ на свойства аморфного гидрированного кремния. О.А. Голикова, Х.Ю. Мавалянов, И.Н. Петров, Р.Р. Яфаев	4,	577
Гетеропереходы II типа GaInAsSb/InAs. М.П. Митайлова, И.А. Андреев, Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, К.Д. Моисеев, Ю.П. Яковлев	4,	678
Зонная структура и оптические спектры сегнетополупроводника $Sn_2P_2Se_6$. И.В. Китык, В.Ю. Фенчак, А.А. Грабар, В.Ю. Сливка	4,	697
Поляризационно-зависимая фотопроводимость в однооснодеформированных узкощелевых полупроводниках. Ф.Т. Василько, С.Г. Гасан-заде, М.В. Стриха, Г.А. Шепельский	4,	708
Жидкие полупроводники с вырожденным электронным газом. В.М. Глазов, В.В. Кольцов	5-6,	806
Энергетический спектр трехмерных и двумерных дырок со снятым спиновым вырождением (исследование теллура) Обзор. В.А. Березовец, И.И. Фарбитейн	5-6,	965
Полярны малого радиуса. Явления переноса. Ю.А. Фирсов	5-6,	994
Структурная сетка и уровень Ферми псевдолегированного аморфного гидрированного кремния. О.А. Голикова, В.Х. Кудоярова	5-6,	1128
3.1.1. Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55)		
Эпитаксиальный рост высокочистого GaAs методом МОС-гидридного осаждения с использованием криофильтрационной очистки арсина. В.В. Валяев, В.Л. Гуртовой, С.Ю. Шаповал, В.А. Киреев, Н.В. Смирнов	1,	175
Амфотерное поведение висмута в пленках селенида свинца. В.А. Зыков, Т.А. Гаврикова, С.А. Немов	2,	309
Центры красной люминесценции в монокристаллах CdS и CdS:Cu и их преобразование при электронном облучении. Н.С. Богданюк, Г.Е. Давидюк, А.П. Шаварова	2,	357
Фотопроводимость, связанная с примесью теллура в германии. А.Ю. Ушаков, Н.Б. Радчук, Р.М. Штеренгас	3,	483
		2285

Роли дырок в формировании коэффициента заполнения заряженных дислокаций в полупроводниках n -типа проводимости. Ю.В. Шикина, Н.И. Шикина	3,	507
Механизм образования проводящих каналов в кристаллах CdS под действием электрического поля. И.А. Дроздова, Б.Е. Ембергенов, Н.Е. Корсунская, И.В. Маркевич, А.Ф. Сингаевский	3,	536
Глубокие центры в монокристаллах сульфида кадмия: новый метод сопоставления данных DLTS различных авторов. А.А. Истратов, О.Ф. Выевенко	4,	654
О некоторых закономерностях электронного спектра примесных центров d -элементов в кремнии. М.С. Юнусов, А. Ахмадалиев, Б.Л. Оксенгендлер, К.А. Бегматов	4,	714
Возбужденные состояния серы и селена в германии. А.Ю. Ушаков, Н.Б. Радчук, Р.М. Штеренгас	4,	754
Физические свойства полуметаллов типа висмута. Г.А. Иванов, В.М. Грабов	5-6,	1040
Основные примесные состояния атомов серебра, замещающих узлы решетки в кристаллах $Ge_{1-x}Si_x$. Р.З. Кязимзаде	5-6,	1105
Энергия связи D^- -центра в квантовой точке. М.А. Одноблюдов, А.А. Пахомов	5-6,	1110
Влияние нелинейности упругих сил и зарядового состояния на тип равновесных искажений дефектов с t_2 -симметрией исходного электронного уровня. Н.С. Аверкиев, А.А. Гуткин, М.А. Рещиков	7,	1207
Влияние ростовых нарушений структуры на дефектообразование в кремнии при внешних воздействиях. Л.А. Казакевич, П.Ф. Лугаков	7,	1226
Электрофотолитографическая спектроскопия глубоких уровней в As_2Se_3 и As_2S_3 . А.М. Андриеш, С.А. Малков, В.И. Верлан	7,	1319
Глубокие центры в фотодиодах, полученных на основе $In_xGa_{1-x}As/InP$ методом газовой эпитаксии из металл-органических соединений. Т.В. Торчинская, В.И. Кушниренко, Б.В. Шербина, К. Майнер	7,	1336
Роль возбужденного состояния в пьезоспектроскопических свойствах акцептора Sn_{A_3} в GaAs. И.В. Костин, Е.Б. Осипов, Н.А. Осипова, Н.О. Сорокина	8,	1382
К вопросу об ионизации изоэлектронной примеси олова в разбавленном твердом растворе $Pb_{1-x}Sn_xSe:Na$. Г.Т. Алексеева, Е.А. Гурьева, П.П. Константинов, Н.В. Максимова, Л.В. Прокофьева	8,	1388
Стабилизация донорного действия галлия в сплавах $Pb_{1-x}Sn_xTe$, облученных электронами. Е.П. Скипетров	8,	1416
Вибронное взаимодействие при внутрицентровых переходах в примесных ионах переходных металлов в полупроводниках. Ежи М. Лангер, А.И. Рыскин	8,	1524
О фотолюминесценции пленок α -Si:H, легированных редкоземельными элементами. Ж. Атаев, В.А. Васильев, И.В. Елизаров, М.М. Мездрогина	9,	1537
Расчет энергетического спектра бинарных полупроводников, легированных редкоземельными элементами. Н.П. Ильин, В.Ф. Мастеров	9,	1591
Свойства бистабильной пары C_1C_2 в кремнии. В.М. Сирацкий, В.И. Шаховцов, В.Л. Шиндич, Л.И. Шпинар, И.И. Ясковец	9,	1707
Исследование глубоких уровней в полужолирующем GaAs методом релаксационной спектроскопии фотоиндуцированного адмиттанса. М.А. Демьяненко, И.В. Марчишин, В.А. Бобылев	10,	1847
Спектры фотопроводимости и проблема примесных состояний в $PbTe(Ga)$. Б.А. Акимов, А.В. Албул, В.Ю. Ильин, М.Ю. Некрасов, Л.И. Рябов	11,	2015
Энергетическая оценка фотолитических центров в Ag_2O . В.А. Волл	11,	2071

Анализ спектров фотолуминесценции слоев GaAs, выращенных из Ga-VI растворов-расплавов. А.Е. Куницын, С.В. Новиков, В.В. Чалдышев, М. Панек, Р. Пашкевич, Б. Пашкевич, М. Тлакзала	11,	2088
О роли неона в образовании магнитно-упорядоченных слоев в кремнии при сверхбольших дозах облучения. А.Ф. Хозлов, А.А. Ежесевский, А.И. Машин, Д.А. Хозлов	12,	2113
Кинетика фотопроводимости PbTe(Ga). В.А. Акимов, А.В. Албул, Л.И. Рябова	12,	2158
Влияние кулоновского взаимодействия на термическую энергию ионизации основной примеси в компенсированном Ge:Ga. А.Г. Андреев, В.В. Воронков, Г.И. Воронкова, А.Г. Забродский, Е.А. Петрова	12,	2218
Излучательная рекомбинация в германии, облученном реакторными нейтронами. В.А. Быковский, В.П. Добрего, Н.И. Долгит, В.В. Емцев, Е.Е. Халлер	12,	2236

3.2. Транспортные явления (PACS 72)

Волна пространственной перезарядки ловушек, сопровождающая изгибные колебания пластины полярного полупроводника. В.В. Свиридов	1,	96
Использование зона-зонной подсветки для определения параметров уровней в методе шумовой спектроскопии. М.Е. Левинштейн, С.Л. Румянцев	1,	140
Влияние поверхностного рассеяния на электропроводность тонкой полупроводниковой пленки в квантующем магнитном поле. Е.Е. Нариманов	2,	235
Механизм образования проводящих каналов в кристаллах CdS под действием электрического поля. И.А. Дроздова, Б.Е. Ембергенов, Н.Е. Корсунская, И.В. Маркевич, А.Ф. Сингаевский	3,	536
Жидкие полупроводники с вырожденным электронным газом. В.М. Глазов, В.Б. Кольцов	5-6,	806
Электрические свойства и фазовые переходы в системах $Tm_{1-x}Sm_xS$ и $Tm_{1-x}La_xS$. И.А. Смирнов, В.В. Попов, А.В. Голубков, А.В. Гольцев, Б.М. Бутмаев	5-6,	857
Основполагающие работы А.Р. Регеля по жидким полупроводникам и современное состояние вопроса. А.А. Андреев	5-6,	924
Низкотемпературный перенос заряда в магнитном поле неравновесными электронами в n -GaAs. Э.Е. Подоксик, М.Г. Лукашевич, В.Г. Мацукевич	5-6,	1070
Динамика и резонансные колебания баллистических электронов в неоднородном полупроводнике. А.Л. Санин, Ю.Л. Ермолаев	7,	1277
Междолинный механизм формирования отрицательной дифференциальной проводимости S-типа в коротких гетероструктурах. А.М. Белянцев, Ю.Ю. Романова	8,	1498
Динамическая локализация и усреднение уравнения движения электрона с произвольной зависимостью энергии от импульса в быстропеременном и постоянном электрическом поле. Ф.Г. Басс	9,	1622
Магнитофононный резонанс на разогретых электронах в антимониде индия. Р.И. Баширов, Р.Р. Баширов, В.А. Елизаров	10,	1870
О роли неона в образовании магнитно-упорядоченных слоев в кремнии при сверхбольших дозах облучения. А.Ф. Хозлов, А.А. Ежесевский, А.И. Машин, Д.А. Хозлов	12,	2113
Исследование пористого карбида кремния методами колебательной и люминесцентной спектроскопии. А.М. Данишевский, В.В. Шуман, А.Ю. Рогачев, П.А. Иванов	12,	2122

ЭДС горячих носителей, обусловленная сортировкой электронов по энергиям в магнитном поле. Г. Гулямов	2,	255
Влияние γ -облучения на электрические параметры тонких пленок SmS . В.В. Каминский, Л.Н. Васильев, Е.Д. Горнушкина, С.М. Соловьев, Г.А. Сосова, Н.М. Володин	2,	306
Механизм образования проводящих каналов в кристаллах CdS под действием электрического поля. И.А. Дроздова, Б.Е. Ембергенов, Н.Е. Корсунская, И.В. Маркевич, А.Ф. Сингаевский	3,	536
Рассеяние дырок на фононах в ферромагнитном полупроводнике HgCr_2Se_4 . Н.Г. Бебенкин	4,	599
Междолинное перераспределение электронов при ударной ионизации мелких доноров в одноосно деформированном Ge . А.Е. Горин, В.Н. Ермаков, В.В. Коломоец	4,	615
Электрические и люминесцентные свойства монокристаллов $n\text{-ZnSe}$, легированных иттербием. Г.Н. Иванова, В.А. Касиян, Д.Д. Недегло	4,	621
Особенности проводимости кристаллов $\text{Cd}_{0.95}\text{Mn}_{0.05}\text{Te}:\text{Co}$. П.Н. Букицкий, Ю.П. Гнатенко, А.Х. Рожко	4,	702
Разогретая неустойчивость при генерации фотоносителей в потенциальной яме $P-i-N$ -гетероструктуры. Б.С. Рывкин, Р.А. Суриц	4,	757
Термогальваномагнитные эффекты в висмуте. Ю.И. Равич, Ю.В. Иванов, А.В. Рапопорт	5-6,	884
Некоторые пути повышения эффективности полупроводниковых термоэлектрических материалов. Ю.А. Бойков, Б.М. Гольцман, В.А. Данилов	5-6,	895
Особенности оптимизации параметров и энергетические возможности термоэлектрических материалов на основе соединений кремния. В.К. Зайцев, М.И. Федоров	5-6,	946
Физические свойства полуметаллов типа висмута. Г.А. Иванов, В.М. Грабов	5-6,	1040
Низкотемпературный перенос заряда в магнитном поле неравновесными электронами в $n\text{-GaAs}$. Э.Е. Подоксик, М.Г. Лукашевич, В.Г. Мацукевич	5-6,	1070
Холл-фактор электронов в кристаллах $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$ при рассеянии на фононах и сплавленном потенциале. Р.З. Кязимзаде	5-6,	1101
Основные примесные состояния атомов серебра, замещающих узлы решетки в кристаллах $\text{Ge}_{1-x}\text{Si}_x$. Р.З. Кязимзаде	5-6,	1105
Функция пространственного распределения неравновесных электронно-дырочных пар при однофотонном возбуждении прямозонных полупроводников. П.Г. Лукашевич	7,	1253
К вопросу об ионизации изоэлектронной примеси олова в разбавленном твердом растворе $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Se}:\text{Na}$. Г.Т. Алексеева, Е.А. Гурьева, П.П. Константинов, Н.В. Максимова, Л.В. Прокофьева	8,	1388
Интжекция и полевая ионизация ловушек в монокристаллах MnGa_2Se_4 . Б.Г. Тагиев, О.Б. Тагиев, Н.Н. Мусаева	8,	1403
Гетероэпитаксиальный рост пленок SiC на основе подложек $\text{AlN}/\text{Al}_2\text{O}_3$. А.Н. Кузнецов, А.А. Лебедев, М.Г. Растегаева, Н.А. Рогачев, Е.И. Теруков, М.П. Щеглов	8,	1425
Прыжковая проводимость по сильно локализованным примесным состояниям индия в твердых растворах $\text{Pb}_{0.78}\text{Sn}_{0.22}\text{Te}$. Ю.И. Равич, С.А. Немов, В.И. Прошин	8,	1448
Токоперенос в МДП структурах $\text{Pd-SiO}_2-n(p)\text{-Si}$ и второй механизм усиления фототока. С.В. Слободчиков, Е.В. Руссу, Х.М. Салитов, М.М. Мередов, А.И. Языева	8,	1517
Исследование параметров, характеризующих электронно-дырочное рассеяние в полупроводниках в условиях низкого		

уровня инжекции. Т.Т. Мнацаканов, Л.И. Поморцева, В.Б. Шу- ман, Е.Г. Гук	9,	1554
Динамическая локализация и усреднение уравнения движения электрона с произвольной зависимостью энергии от импульса в быстропеременном и постоянном электрическом поле. Ф.Г. Басс	9,	1622
Исследование электрофизических свойств пленок α -C:H, пер- спективных для защитных покрытий электрофотографиче- ских носителей информации. В.Х. Кудоярова, В.Л. Аверьянов, А.В. Чернышев, М.Б. Цолов	9,	1662
Межзонные оже-переходы и время жизни носителей заряда в вырожденных узкощелевых полупроводниках p -типа проводимости. А.В. Дмитриев, А.Б. Евлютин	10,	1733
Предельная термоэлектрическая добротность полупроводнико- вых кристаллических материалов. Л.П. Булат, В.С. Загордо- нец	10,	1743
Экспериментальное изучение влияния одноосного давления на эффекты горячих дырок в p -германии в продольных электрических полях. В.Г. Бельт, А.Т. Далакян, В.Н. Тулаупенко, В.А. Фирсов	10,	1764
О критерии перехода Мотта в плоских решетках. А.Г. Кязым-заде О контуре спектра излучения электронно-дырочной плазмы при одnofотонном возбуждении прямозонных полупроводников. П.Г. Лукашевич	10, 11,	1915 2002
Электрические и магнитные свойства полумагнитных полупро- водников $Hg_{1-x}Mn_xTe_{1-y}Se_y$. В.А. Кульбачинский, П.Д. Ма- рьяччук, И.А. Чурилов	11,	2007
О кинетике тока и кинетических коэффициентах в импульсных полях. В.Г. Джакели, З.С. Качлишвили, Н.Ю. Матешели	11,	2033
Определение диффузионно-рекомбинационных параметров по- лупроводников бесконтактным методом. А.В. Штурбин, В.А. Шалыгин, В.И. Стафеев	11,	2039
Энергетическая оценка фотолитических центров в Ag_2O . В.А. Вола Переходметалл-диэлектрик в сильно легированных p^+ -квантовых ямах на поверхности кремния n -типа. Н.Т. Баграев, Е.В. Владимирская, В.Э. Гасумянц, В.И. Кайданов, В.В. Кведер, Л.Е. Клячкин, А.М. Маларенко, Е.И. Чайкина, А.И. Шалыгин	11, 12,	2071 2133
Влияние кулоновского взаимодействия на термическую энергию ионизации основной примеси в компенсированном Ge:Ga. А.Г. Андреев, В.В. Воронков, Г.И. Воронкова, А.Г. Забродский, Е.А. Петрова	12,	2218

3.2.2. Фотопроводимость и фотовольтаический эффект (PACS 72.40)

Примесный фоторезистор в режиме импульсного оптического гетеродинамирования. Г.А. Асланов, Т.М. Бурбаев, В.А. Курбатов, Н.А. Пенин	1,	9
Определение параметров зонной структуры $CdAs_2$ методами оптического пропускания и фотопроводимости. В.А. Морозо- ва, Т.В. Семенова, С.М. Лосева, О.Г. Кошелев, С.Ф. Маренкин, А.М. Раушман	3,	393
Фотоэлектрический эффект в GaP поверхностно-барьерных структурах: температурная зависимость коротковолновой квантовой эффективности. Ю.А. Гольберг, О.В. Константинов, Е.А. Поссе, Б.В. Царенков	3,	421
Обнаружение фоточувствительности гетероконтактов полупро- водник-зеленые листья. В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, В.Х. Шпунт	3,	438
Фотопроводимость, связанная с примесью теллура в германии. А.Ю. Ушаков, Н.Б. Радчук, Р.М. Штеренгас	3,	483

Поверхная фотоэдс в гетероэпитаксиальной структуре. Л.В. Шевцов, А.В. Саченко, Ю.М. Шеварц	3,	566
Особенности проводимости кристаллов $Cd_{0.95}Mn_{0.05}Te:Co$. П.Н. Буквиский, Ю.П. Гнатынко, А.Х. Рожко	4,	702
Поляризационно-зависимая фотопроводимость в одноосно-деформированных узкощелевых полупроводниках. Ф.Т. Васько, С.Г. Гасан-заде, М.В. Стрига, Г.А. Шепельский	4,	708
Композиционные покрытия с матрицей из сульфида свинца для фотопроводящих слоев. В.С. Манько, В.А. Андреев, С.П. Чащин, И.Г. Хабибуллин, Э.А. Закирова	4,	718
Дефектообразование в кремнии при протонном облучении. С.Е. Мальганов	4,	725
Фотоэлектрические свойства сильно компенсированных пленок сульфида свинца, сформированных при помощи радиационных технологий. С.П. Зимин, Р.Ф. Зайкина	4,	729
Применение метода сильноосигнальной конденсаторной фотоэдс для определения некоторых параметров. С.В. Тихов	4,	742
Возбужденные состояния серы и селена в германии. А.Ю. Ушаков, Н.Б. Радчук, Р.М. Штеренгас	4,	754
Фототок в структуре $AlGaAs/GaAs$ с затвором Шоттки, содержащей одиночную квантовую яму. С.В. Жоловец, Р. Гольдман, Г. Гобиш, Н. Штайн, Д.М. Чемберлен, Т.С. Ченг, М. Хенини	7,	1237
Эффект фотопамати в высокоомных фоточувствительных монокристаллах $CdS:Cu$. Э.Н. Заманова, М.А. Джафаров	8,	1411
Фотоэлектрические свойства контактов $Ni-ZnSe$. В.П. Магний, В.В. Мельник	8,	1468
Токоперенос в МДП структурах $Pd-SiO_2-n(p)-Si$ и второй механизм усиления фототока. С.В. Слободчиков, Е.В. Руссу, Х.М. Салихов, М.М. Мередов, А.И. Языева	8,	1517
Особенности спектра длинноволновой примесной фотопроводимости в компенсированном германии. Ю.П. Дружинин, Е.Г. Чиркова	9,	1575
Фоточувствительность эпитаксиальной структуры $p-GaAs/n-GaAs/p-Si$. Л.А. Иванютин, Ф.М. Кацанов, С.Ю. Разлей, И.Н. Цыпленков	10,	1750
О влиянии приповерхностной области пространственного заряда на фотопроводимость $Cd_xHg_{1-x}Te$ ($x \approx 0.3$). Э.К. Гусейнов, Н.Д. Исмаилов	10,	1790
Спектры фотопроводимости и проблема примесных состояний в $PbTe(Ga)$. Б.А. Акимов, А.В. Албул, В.Ю. Ильин, М.Ю. Некрасов, Л.И. Рябов	11,	2015
Энергетическая оценка фотолитических центров в Ag_2O . В.А. Волл	11,	2071
Фотоэлектрические явления в структурах на высокоомных полупроводниковых кристаллах с тонким слоем диэлектрика на границе полупроводник-металл. П.Г. Кашерининов, А.В. Кичаев, А.А. Томасов	11,	2092
Кинетика фотопроводимости $PbTe(Ga)$. Б.А. Акимов, А.В. Албул, Л.И. Рябов	12,	2158
Исследование фотоэдс и фотоиндуцированного захвата заряда в пористом кремнии. А.Б. Матвеева, Е.А. Константинова, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров	12,	2180

3.3. Электронная структура и электрические свойства поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 73)

Особенности фотоэффекта в резких изотипных $N^+-n^0-n^+$ -гетероструктурах. И.А. Жебулев, В.И. Корольков, Т.С. Табаров	3,	448
Электродинамика двумерных электронных систем. Обзор. А.Я. Шик	8,	1345

3.3.1. Электронные состояния на поверхностях и границах раздела (PACS 73.20)

Люминесценция локализованных электронно-дырочных пар в области фундаментального поглощения структур Zn(S,Se)-(Zn,Cd)Se с квантовыми ямами. Н.Н. Леденцов, С.В. Иванов, В.М. Максимов, И.В. Седова, И.Г. Табатадзе, П.С. Копьев	1,	65
Образование конденсонов в квазидвумерных слоях дырочных полупроводников. О.В. Кибис	1,	125
Уровни энергий в квантовой яме с прямоугольными стенками сложной формы. В.Д. Дымников, О.В. Константинов	1,	133
Электронные свойства реальной и сульфидированной поверхности GaAs. Е.Ф. Венгер, С.И. Кириллова, В.Е. Примаченко, В.А. Чернобай	2,	244
Влияние квантового магнитного поля на энергетический спектр электронов в квазидвумерных слоях многодолинных полупроводников. О.В. Кибис	2,	259
Примесные состояния 3d-ионов в квантовых ямах и сверхрешетках I типа. К.А. Кикоин, Л.А. Манакова	2,	291
Зависимость параметров центров, образующих глубокие уровни во фториде кальция, выращенном на кремнии, от режима молекулярно-лучевой эпитаксии. Х. Альварес, Л.С. Берман, И.Н. Каримов	3,	405
Генерация электронно-дырочных пар у поверхности полупроводника в краевых полях макроскопических заряженных кластеров: эффекты электрических неоднородностей различных масштабов. Е.И. Гольдман, А.Г. Ждан	3,	428
Рассеяние электронов на оптических фононах в двумерных квантовых ямах с независимым захватом электронов и фононов. Ю. Пожела, В. Юцене	3,	459
Оптические и электрические свойства сверхрешеток Фибоначчи PbS-C, полученных методом импульсного лазерного напыления. С.Ф. Муситин, Л.Г. Бакуева, В.И. Ильин, О.В. Рабизо, Л.В. Шаронова	3,	474
Раздельный транспорт электронов и дырок через систему нелегированных квантовых ям. С.С. Кучеренко, В.С. Рыжкин, А.Я. Шик	3,	487
U ⁻ центры в селективно легированных гетероструктурах. С.Г. Дмитриев, Б.К. Медведев, В.Г. Мокеров, О.Г. Шагимуратов	3,	500
Многофононный захват носителей на глубокие центры в квантовых ямах. А.А. Патомов, И.Н. Ясевич	3,	511
Релаксация заряда в кремнии на границах зерен, обогащенных кислородом и углеродом. Ю.М. Ильящук, А.К. Федотов	3,	532
Исследование поверхностных состояний в МДП структурах методом двухтемпературной полной проводимости. Е.Н. Боромотов, С.В. Котов, С.В. Лукин, С.В. Головин	4,	646
Гетеропереходы II типа GaInAsSb/InAs. М.П. Михайлова, И.А. Андреев, Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, К.Д. Мусеев, Ю.П. Яковлев	4,	678
Дефектообразование в кремнии при протонном облучении. С.Е. Мальзанов	4,	725
Применение метода сильносигнальной конденсаторной фотоэдс для определения некоторых параметров. С.В. Титов	4,	742
Трехмерные кластерные решетки. В.Н. Богомолов, Т.М. Павлова	5-6,	826
Энергетический спектр трехмерных и двумерных дырок со снятым спиновым вырождением (исследование теллура) Обзор. В.А. Березовец, И.И. Фарбитейн	5-6,	965

Экспериментальное определение энергии донорных центров, локализованных на границах квантовой ямы GaSb/InAs/GaSb. А.П. Дмитриев, С.А. Емельянов, С.В. Иванов, В.Я. Мельцер, Я.В. Терентьев, И.Д. Ярошецкий	5-6,	1076
Межподзонное поглощение света в квантовой яме полупроводника со сложной зонной структурой. Л.Е. Голуб, Е.Л. Ивченко, Р.Я. Расулов	5-6,	1093
Энергия связи D ⁻ -центра в квантовой точке. М.А. Одноблюдов, А.А. Патомов	5-6,	1110
Интерфейсные электронные состояния вблизи плавного гетероперехода HgTe-CdTe. А.В. Германенко, Г.М. Миньков, В.А. Ларионова, О.Э. Рут	7,	1259
Захват носителей в квантовые ямы и их термический выброс в полупроводниках A ^{III} B ^V . С.А. Соловьев, И.Н. Ясевич, В.М. Чистяков	7,	1264
Определение характеристик двумерного электронного газа в структурах InGaAs/InP акустическими методами в режиме квантового эффекта Холла. И.Л. Дричко, А.М. Дьяконов, В.Д. Казан, А.М. Крещук, Г.Д. Кипшидзе, Т.А. Полянская, И.Г. Савельев, И.Ю. Смирнов, А.В. Сулов, А.Я. Шик	7,	1306
Сульфидная пассивация поверхности GaAs: открепление уровня Ферми. Б.И. Бедный, Н.В. Байдусь	8,	1488
Туннелирование электронов в гетероструктурах с одиночным барьером и симметричными спейсерами в продольном магнитном поле. Т.Г. Андерсон, Ю.В. Дубровский, И.А. Ларкин, С.В. Морозов, Ю.Н. Ханн	9,	1546
Туннельная релаксация дырок в двойных квантовых ямах с неидеальными гетерограницами. Ф.Т. Васько, О.Э. Райчев	9,	1579
Длинноволновое излучение при разогреве двумерных дырок продольным электрическим полем в квантовых ямах гетероструктур GaAs-AlGaAs. Л.Е. Воробьев, Д.В. Донецкий, А. Кастальский	10,	1771
Квантовый эффект Холла в образце нестандартной геометрии. Б.А. Аронзон, Н.А. Городилов, А.Л. Чернов, Г.Л. Штропенин	10,	1822
О немонотонной зависимости туннельной прозрачности от толщины барьеров для неупорядоченной сверхрешетки с примесями в барьерах. А.Н. Король	10,	1844
Особенности нелинейного отражения электромагнитных волн от многослойной структуры, связанные с разогревом электронного газа в легированном слое n-GaAs. А.И. Воронко, С.Е. Куменков, Г.Н. Шкерлин	11,	2024
Особенности динамической локализации электрона в квантовой полупроводниковой сверхрешетке в быстропеременном электромагнитном и постоянном магнитном полях. Ю.О. Аверков, Ф.Г. Басс, А.П. Панчета	11,	2062
Переход металл-диэлектрик в сильно легированных p ⁺ -квантовых ямах на поверхности кремния n-типа. Н.Т. Баграев, Е.В. Владимирская, В.Э. Гасумянц, В.И. Кайданов, В.В. Кведер, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, Е.И. Чайкина, А.И. Шальгин	12,	2133

3.3.2. Барьеры Шоттки (PACS 73.30)

Влияние нейтронного и космического излучения на характеристики полевого транзистора с затвором Шоттки. С.В. Оболенский, Г.П. Павлов	3,	413
Фотоэлектрический эффект в GaP поверхностно-барьерных структурах: температурная зависимость коротковолновой квантовой эффективности. Ю.А. Гольберг, О.В. Константинов, Е.А. Поссе, В.В. Царенков	3,	421
Высота барьера Шоттки с тонким сильно легированным слоем полупроводника. В.В. Чикун	3,	563

Применение метода сильноосигнальной конденсаторной фотоэкс для определения некоторых параметров. С.В. Тихов	4,	742
Поверхностно-барьерные структуры CdS с промежуточным тонким варизонным слоем. Ю.Н. Бобренко, А.М. Павелец, С.Ю. Павелец, Т.Е. Шенгелия	4,	750
Полевой транзистор на основе 6H-SiC с затвором в виде диода Шоттки. А.А. Лебедев, М.М. Анихин, А.Н. Кузнецов, М.Г. Растегаева, Н.С. Савкина, А.Л. Сыркин, В.Е. Челноков	7,	1231
Фотоэлектрические свойства контактов Ni-ZnSe. В.П. Мазний, В.В. Мельник	8,	1468
Высота барьера в диодах Шоттки, сформированных на основе n-SiC-6H. А.Н. Андреев, А.А. Лебедев, М.Г. Растегаева, Ф.М. Снегов, А.Л. Сыркин, В.Е. Челноков, Л.Н. Шестопалова	10,	1833
3.3.3. Транспортные явления в структурах, содержащих границы раздела (PACS 73.40)		
Коэффициент неидеальности ВАХ p-n-перехода при разогреве носителей заряда и фононов. Г. Гулямов, К.Б. Умаров	1,	33
Влияние особенностей Cd _z Hg _{1-z} Te на характеристики длинноволновых МДП транзисторов. А.А. Градобоев, Ш.Д. Курмашев	1,	51
К вопросу о вольт-амперной характеристике гетероструктуры на основе неупорядоченного селенида цинка. А.П. Беляев	1,	70
Фотоэффект в эпитаксиальной p ⁺ -n-структуре с n-областью переменной толщины и контактом туннельный окисел-металл. М.Г. Барышев, Б.С. Муравский, В.Н. Черный, И.Л. Яманов	1,	91
Моделирование процессов перетекания при латеральном транспорте в двухъямной наноструктуре. В.Ф. Елесин, О.А. Винокуров, В.Е. Кондрашов, А.П. Подливаев, В.Н. Шамраев	1,	183
Влияние электрон-электронного рассеяния на перенос носителей заряда в n-канале кремниевого субмикронного полевого транзистора: метод Монте-Карло. В.М. Борздов, О.Г. Жевняк, Ф.Ф. Комаров	2,	193
Оптическое управление переключением и механизм запираания p-n-i-n ⁺ -структуры импульсом напряжения положительной полярности. З.С. Калантарова	2,	209
Механизм формирования стационарных обратных вольт-амперных характеристик МДП структур с переносом заряда. И.В. Гретов, А.Ф. Шулекин, М.И. Векслер	2,	229
Исследование поверхностных состояний на границе раздела SiO ₂ -SiC путем анализа входной комплексной проводимости МОП структуры в широком температурном интервале. П.А. Иванов, В.Н. Пантелеев, Т.П. Самсонова, В.Е. Челноков	2,	271
Исследование кинетики термостимулированной релаксации объемного заряда в окисле SiO ₂ структур металл-окисел-полупроводник, облученных γ-квантами ⁶⁰ Со. Ю.В. Баринов, В.Н. Безбородов, В.В. Емельянов, В.С. Першенков	2,	323
Поперечный электронный транспорт в туннельно-резонансных структурах с двумерными носителями заряда. А.Е. Беляев, С.А. Витусевич, Р.В. Конакова, Л.Н. Кравченко, И.Ю. Ильин	2,	349
Эпитаксиальные p-n-структуры из GaAs на Si-подложках: электрические, фотоэлектрические и электролюминесцентные свойства. В.В. Еестропов, Ю.В. Жилев, Н. Назаров, Ю.Г. Садофьев, А.Н. Топчий, Н.Н. Фалеев, Л.М. Федоров, Ю.М. Шерняков	3,	385
Генерация электронно-дырочных пар у поверхности полупроводника в краевых полях макроскопических заряженных кластеров: эффекты электрических неоднородностей различных масштабов. Е.И. Гольдман, А.Г. Ждан	3,	428

Оптические и электрические свойства сверхрешеток Фибоначчи $PbS-C$, полученных методом импульсного лазерного напыления. С.Ф. Муситин, Л.Г. Бакуева, В.И. Ильин, О.В. Рабизо, Л.В. Шаронова	3,	474
Раздельный транспорт электронов и дырок через систему нелегированных квантовых ям. С.С. Кучеренко, В.С. Рыжкин, А.Я. Шик	3,	487
U^- -центры в селективно легированных гетероструктурах. С.Г. Дмитриев, Б.К. Медведев, В.Г. Мокеров, О.Г. Шагмуратов	3,	500
Исследование поверхностных состояний в МДП структурах методом двухтемпературной полной проводимости. Е.Н. Боромонтов, С.В. Котов, С.В. Лукин, С.В. Головин	4,	646
Гетеропереходы II типа $GaInAsSb/InAs$. М.П. Михайлова, И.А. Андреев, Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, К.Д. Моисеев, Ю.П. Яковлев	4,	678
Особенности вольт-амперной характеристики асимметричной системы квантовых ям $GaAs/AlGaAs$ с широкими барьерами между ними. В.И. Кадушкин, В.В. Капаев, И.В. Кучеренко, А.И. Подливаев, И.А. Руднев, А.А. Синченко, Е.Л. Шангина	4,	720
Применение метода сильносигнальной конденсаторной фотодс для определения некоторых параметров. С.В. Титов	4,	742
Разогретая неустойчивость при генерации фотоносителей в потенциальной яме $P-i-N$ -гетероструктуры. В.С. Рыжкин, Р.А. Суриц	4,	757
Поверхностно-барьерные структуры $CdSe_xTe_{1-x}$ для солнечных элементов. А.М. Павелец, С.Ю. Павелец, Т.М. Севидзе	5-6,	1061
Фотоэлектрические свойства контакта полупроводников с зелеными листьями. В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, В.Х. Шпунт	7,	1178
Времена жизни и диффузионные длины неравновесных носителей заряда в SiC $p-n$ -структурах. А.М. Стрельчук	7,	1190
Свойства лавинных фотодиодов на основе гетероперехода $Si-TiO_2$. А.П. Болтаев, Т.М. Бурбаев, Г.А. Калюжная, В.А. Курбатов, Т.И. Осина, Н.Н. Соловьев	7,	1220
Полевой транзистор на основе $6H-SiC$ с затвором в виде диода Шоттки. А.А. Лебедев, М.М. Аникин, А.Н. Кузнецов, М.Г. Растегаева, Н.С. Сапкина, А.Л. Сыркин, В.Е. Челмоков	7,	1231
Фототок в структуре $AlGaAs/GaAs$ с затвором Шоттки, содержащей одиночную квантовую яму. С.В. Жоговец, Р. Гольдман, Г. Гоби, Н. Штайн, Д.М. Чемберлен, Т.С. Ченг, М. Хенини	7,	1237
Определение характеристик двумерного электронного газа в структурах $InGaAs/InP$ акустическими методами в режиме квантового эффекта Холла. И.Л. Дричко, А.М. Дьяконов, В.Д. Казан, А.М. Крещук, Г.Д. Кипшидзе, Т.А. Полянская, И.Г. Савельев, И.Ю. Смирнов, А.В. Суслев, А.Я. Шик	7,	1306
Изучение спектральной катодолюминесценции квантовых ям в гетероструктурах на основе $A^{III}B^V$ с помощью акустооптического монохроматора. В.Л. Деноткин, С.М. Копылов, В.Г. Кризгаль, О.А. Лабутин, А.В. Тарасов	7,	1329
Светоуправляемые электрические поля в высокоомной МДПДМ структуре с туннельно-прозрачным диэлектриком. Б.И. Резников, Г.В. Царенков	8,	1430
Самовыключение тока ударной ионизации в $p-n$ -переходе. В.Н. Добровольский, А.В. Романов, С.В. Грязнов	8,	1453
Междолинный механизм формирования отрицательной дифференциальной проводимости S -типа в коротких гетероструктурах. А.М. Белянцев, Ю.Ю. Романова	8,	1498
Аналитическая модель распространения фронта ударной ионизации в диодной структуре большой площади. А.М. Минарский, П.В. Родин	8,	1506

Токоперенос в МДП структурах Pd-SiO ₂ -n(p)-Si и второй механизм усиления фототока. С.В. Слободчиков, Е.В. Руссу, Х.М. Салихов, М.М. Мередов, А.И. Языева	8, 1517
Туннелирование электронов в гетероструктурах с одиночным барьером и симметричными спейсерами в продольном магнитном поле. Т.Г. Андерсон, Ю.В. Дубровский, И.А. Ларкин, С.В. Морозов, Ю.Н. Ханин	9, 1546
Получение и исследование 6H-SiC эпитаксиально-диффузионных p-n-структур. А.А. Лебедев, А.Н. Андреев, А.А. Мальцев, М.Г. Растегаева, Н.С. Савкина, В.Е. Челноков	9, 1635
Энергетическая релаксация горячих носителей в полупроводниковой короткопериодной сверхрешетке. О.Э. Грешневикова, С.В. Иванов, П.С. Копьев, В.Ю. Некрасов, В.Н. Трутин, И.Д. Ярошецкий	9, 1674
Нестационарная теория возмущений для задач о прохождении электронов через квантово-размерные структуры в высокочастотных полях. А.Б. Пашковский	9, 1712
Фотоэлектрические эпитаксиальной структуры p-GaAs/n-GaAs/p-Si. Л.А. Иванютин, Ф.М. Кацанов, С.Ю. Разлей, И.Н. Цыпленков	10, 1750
Барьерная термоэдс на p-n-переходе. И.И. Балмуш, З.М. Дашевский, А.И. Касиян	10, 1796
Влияние последовательного сопротивления на термостимулированный ток в p-n-переходе. Н.А. Урманов, М.В. Гафурова	10, 1805
Квантовый эффект Холла в образце нестандартной геометрии. Б.А. Аронзон, Н.А. Городилов, А.Л. Чернов, Г.Л. Штропенин	10, 1822
О немонотонной зависимости туннельной прозрачности от толщины барьеров для неупорядоченной сверхрешетки с примесями в барьерах. А.Н. Король	10, 1844
Динамика термической генерации свободных носителей заряда у границы раздела полупроводник-диэлектрик в условиях релаксации заселенности объемных центров генерации. С.Г. Дмитриев, А.Г. Ждан, Н.Ф. Кухарская, Ю.В. Маркин	10, 1906
Пространственный заряд инжектированных баллистических электронов с отрицательной эффективной массой. Н.З. Вагидов, З.С. Грибников, А.Н. Коршак	11, 1944
Промежуточное состояние управляемой четырехслойной p-n-p-n-структуры. Н.З. Вагидов, З.С. Грибников, А.Н. Коршак, В.В. Митин	11, 1958
Особенности нелинейного отражения электромагнитных волн от многослойной структуры, связанные с разогревом электронного газа в легированном слое n-GaAs. А.И. Воронко, С.Е. Куменков, Г.Н. Шкерлин	11, 2024
Трансформация спектра термостимулированного тока в n ⁺ -π-p-переходе при учете электрического поля в нейтральном слое π-области. Н.А. Урманов	11, 2053
Фотоэлектрические явления в структурах на высокоомных полупроводниковых кристаллах с тонким слоем диэлектрика на границе полупроводник-металл. П.Г. Кашерининов, А.В. Кичаев, А.А. Томасов	11, 2092
Прямой и обратный ток p-n-структур на основе 6H-SiC, изготовленных бесконтейнерной жидкостной эпитаксией. А.М. Стрельчук, В.В. Евстропов, В.А. Дмитриев, А.Е. Черенков	12, 2169
Темновое распределение электрического поля и ток в высокоомных сильно смещенных структурах металл-диэлектрик-полупроводник. Б.И. Резников, Г.В. Царенков	12, 2189

Влияние поверхностного рассеяния на электропроводность тонкой полупроводниковой пленки в квантующем магнитном поле. <i>Е.Е. Нариманов</i>	2,	235
Баллистические токи, ограниченные пространственным зарядом, в легированных тонких токопроводящих каналах. <i>Н.З. Вагидов, З.С. Грибников, А.Н. Коршак</i>	3,	553
Поверхностно-барьерные структуры $CdSe_xTe_{1-x}$ для солнечных элементов. <i>А.М. Павелец, С.Ю. Павелец, Т.М. Сванидзе</i>	5-6,	1061
Фототок в структуре $AlGaAs/GaAs$ с затвором Шоттки, содержащей одиночную квантовую яму. <i>С.В. Жоговец, Р. Гольдман, Г. Гоби, Н. Штайн, Д.М. Чемберлен, Т.С. Ченг, М. Хенчичи</i>	7,	1237
Захват носителей в квантовые ямы и их термический выброс в полупроводниках $A^{III}B^V$. <i>С.А. Соловьев, И.Н. Ясевич, В.М. Чистяков</i>	7,	1264
Определение характеристик двумерного электронного газа в структурах $InGaAs/InP$ акустическими методами в режиме квантового эффекта Холла. <i>И.Л. Дричко, А.М. Дьяконов, В.Д. Казан, А.М. Крещук, Г.Д. Кипшидзе, Т.А. Полянская, И.Г. Савельев, И.Ю. Смирнов, А.В. Сулов, А.Я. Шик</i>	7,	1306
Влияние температуры роста на подвижность электронов в транзисторных структурах $InAlAs/InGaAs$, выращенных на подложках InP методом молекулярно-пучковой эпитаксии. <i>В.М. Устинов, А.Ю. Егоров, А.Е. Жукон, Н.Н. Фалеев, А.Ф. Цапуньников, П.С. Копьев</i>	8,	1442
Аналитическая модель распространения фронта ударной ионизации в диодной структуре большой площади. <i>А.М. Минарский, П.Б. Родин</i>	8,	1506
Туннелирование электронов в гетероструктурах с одиночным барьером и симметричными спейсерами в продольном магнитном поле. <i>Т.Г. Андерсон, Ю.В. Дубровский, И.А. Ларкин, С.В. Морозов, Ю.Н. Ханин</i>	9,	1546
Туннельная релаксация дырок в двойных квантовых ямах с неидеальными гетерограницами. <i>Ф.Т. Васько, О.Э. Райчев</i>	9,	1579
Фотостимулированное усиление фононов, локализованных в двумерном электронном газе. <i>Э.М. Эпштейн</i>	9,	1585
О влиянии приповерхностной области пространственного заряда на фотопроводимость $Cd_xHg_{1-x}Te$ ($x \approx 0.3$). <i>Э.К. Гусейнов, Н.Д. Исмаилов</i>	10,	1790
Динамика термической генерации свободных носителей заряда у границы раздела полупроводник-диэлектрик в условиях релаксации заселенности объемных центров генерации. <i>С.Г. Дмитриев, А.Г. Ждан, Н.Ф. Кузарская, Ю.В. Маркин</i>	10,	1906
Особенности нелинейного отражения электромагнитных волн от многослойной структуры, связанные с разогревом электронного газа в легированном слое $n-GaAs$. <i>А.И. Воронко, С.Е. Куменков, Г.Н. Шкерлин</i>	11,	2024
Особенности динамической локализации электрона в квантовой полупроводниковой сверхрешетке в быстропеременном электромагнитном и постоянном магнитном полях. <i>Ю.О. Аверков, Ф.Г. Басс, А.П. Панчева</i>	11,	2062

3.4. Магнитные свойства (PACS 75), магнитные резонансы (PACS 76)

Рассеяние дырок на фононах в ферромагнитном полупроводнике $HgCr_2Se_4$. <i>Н.Г. Бебенин</i>	4,	599
Магнитофононный резонанс на разогретых электронах в антимониде индия. <i>Р.И. Баширов, Р.Р. Баширов, В.А. Елизаров</i>	10,	1870

Исследование структуры поверхности пористого кремния методом ядерного магнитного резонанса. А.И. Мамыкин, А.Ю. Ильин, В.А. Мошников, Н.Е. Мокроусов, А.А. Мамыкин, А.И. Першин	10,	1874
Электрические и магнитные свойства полумангнитных полупроводников $Hg_{1-x}Mn_xTe_{1-y}Se_y$. В.А. Кульбачинский, П.Д. Марьянчук, И.А. Чурилов	11,	2007
О роли неона в образовании магнитно-упорядоченных слоев в кремнии при сверхбольших дозах облучения. А.Ф. Холлов, А.А. Ежевский, А.И. Машин, Д.А. Холлов	12,	2113

3.5. Оптические свойства полупроводников, спектроскопия, взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78)

3.5.1. Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20)

Локальные оптические колебания вблизи точечных и линейных дефектов в полупроводниках. Ф.Г. Басс, В.Л. Фалько, С.И. Ханкина	1,	114
Энергетический спектр $Pb_{0.995-x}Sn_{0.005}Na_xSe$ по данным оптического поглощения. А.Н. Вейс, Н.А. Суворова	2,	278
Зависимость характерных размеров крупномасштабных скоплений электрически активных дефектов от их положения вдоль продольной оси монокристаллического слитка $InP:Fe$. В.А. Юрьев, В.П. Калинушкин	2,	316
Определение параметров зонной структуры $CdAs_2$ методами оптического пропускания и фотопроводимости. В.А. Морозова, Т.В. Семененя, С.М. Лосева, О.Г. Кошелев, С.Ф. Маренкин, А.М. Рауцман	3,	393
Визуализация крупномасштабных скоплений электрически активных дефектов в монокристаллах фосфида индия и арсенида галлия. В.А. Юрьев, В.П. Калинушкин, О.В. Астафьев	3,	455
Зонная структура и оптические спектры сегнетополупроводника $Sn_2P_2Se_6$. И.В. Китык, В.Ю. Фенчак, А.А. Грабар, В.Ю. Сливка	4,	697
Крупномасштабные скопления электрически активных дефектов в монокристаллах $InP:As$ и $InP:Ga$. В.А. Юрьев, В.П. Калинушкин	5-6,	1080
Функция пространственного распределения неравновесных электронно-дырочных пар при однофотонном возбуждении прямозонных полупроводников. П.Г. Лукашевич	7,	1253
Влияние имплантации ионов Ag^+ на рассеяние света монокристаллами нелегированного фосфида индия. В.А. Юрьев, В.П. Калинушкин	7,	1313
Поглощение и фотолюминесценция свободного пористого кремния. Е.В. Астрова, А.А. Лебедев, А.Д. Ременюк, Ю.В. Рудь	9,	1649
Исследование электрофизических свойств пленок $\alpha-C:H$, перспективных для защитных покрытий электрофотографических носителей информации. В.Х. Кудоярова, В.Л. Аверьянов, А.В. Чернышев, М.Б. Цолов	9,	1662
Получение халькопиритных пленок $CuGa_xIn_{1-x}Se_2$ импульсным лазерным испарением. В.Ф. Гременок, В.В. Кундяк, Е.П. Заречкая, А.С. Кундяк, И.А. Викторов, И.В. Боднарь, Ю.В. Рудь	9,	1692
Температурная зависимость показателя преломления $Cd_xHg_{1-x}Te$. В.Г. Средин, В.М. Укроженко	10,	1729

3.5.2. Инфракрасная спектроскопия, комбинационное рассеяние (PACS 78.30)

Комбинационное рассеяние света и фотолюминесценция пористого кремния. В.А. Караванский, А.Н. Образцов	4,	582
---	----	-----

Резонансное рамановское рассеяние света на интерфейсных фоновых в сверхрешетке GaAs/AlAs в сильном магнитном поле. Д.Н. Мирлин, А.А. Сиренко, Р. Плanelь	4,	636
Структурная сетка и уровень Ферми псевдoleгированного аморфного гидрированного кремния. О.А. Голикова, В.Х. Кудоярова	5-6,	1128
О встраивании азота в сетку аморфного гидрированного кремния. Н.С. Жданович	8,	1502
Дальняя инфракрасная фотопроводимость кремния, облученного быстрыми нейтронами. В.Г. Голубев, Г.И. Кропотов, А.В. Пачекин, Н.А. Соболев, Е.И. Шек, А.А. Дукин	10,	1878
Влияние поверхностного потенциала на комбинационное рассеяние света в фосфиде индия. А.Н. Образцов, А.А. Гоманюк, А.В. Микуленок, Ф.С. Терра	11,	2082
Исследование пористого карбида кремния методами колебательной и люминесцентной спектроскопии. А.М. Данишевский, В.Б. Шуман, А.Ю. Рогачев, П.А. Иванов	12,	2122

3.5.3. Люминесценция, излучательная рекомбинация (PACS 78.55; 78.60)

Люминесценция локализованных электронно-дырочных пар в области фундаментального поглощения структур Zn(S,Se)-(Zn,Cd)Se с квантовыми ямами. Н.Н. Леденцов, С.В. Иванов, В.М. Максимов, И.В. Седова, И.Г. Табатадзе, П.С. Копьев	1,	65
Эпитаксиальный рост высокочистого GaAs методом МOC-гидридного осаждения с использованием криофилтративной очистки арсина. В.В. Валеев, В.Л. Гуртовой, С.Ю. Шаповал, В.А. Киреев, Н.В. Смирнов	1,	175
Отжиг центров зеленой люминесценции сульфида кадмия. Н.С. Богданюк, Г.Е. Давидюк, А.П. Шаварова	2,	201
Процессы излучательной рекомбинации в двойных гетероструктурах InAsSbP/InAsSb/InAsSbP. М.С. Бреслер, О.Б. Гусев, М. Айдаралиев, Н.В. Зотова, С.А. Карандашев, В.А. Матвеев, М.Н. Стусь, Г.Н. Талалакин	2,	219
Фотолюминесценция монокристаллов CuAl ₂ In _{1-x} S ₂ . И.В. Боднарь, Ф.Л. Кесаманлы, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь	2,	318
Трансформация системы дефектов по толщине пластины CdTe при диффузионном легировании галлием. В.Н. Бабенцов, А.И. Власенко, Н.И. Тарбаев	2,	328
Излучательная рекомбинация в монокристаллах селенида цинка, активированных кислородом. Ю.Ф. Ваксман	2,	346
Центры красной люминесценции в монокристаллах CdS и CdS:Cu и их преобразование при электронном облучении. Н.С. Богданюк, Г.Е. Давидюк, А.П. Шаварова	2,	357
Эпитаксиальные p-n-структуры из GaAs на Si-подложках: электрические, фотоэлектрические и электролюминесцентные свойства. В.В. Евстропов, Ю.В. Жилаев, Н. Назаров, Ю.Г. Садофьев, А.Н. Топчий, Н.Н. Фалеев, Л.М. Федоров, Ю.М. Шерняков	3,	385
Эффект охлаждения, вызываемый отрицательной люминесценцией. В.И. Пупа	3,	526
Комбинационное рассеяние света и фотолюминесценция пористого кремния. В.А. Караванский, А.Н. Образцов	4,	582
Электрические и люминесцентные свойства монокристаллов n-ZnSe, легированных иттербием. Г.Н. Иванова, В.А. Касиян, Д.Д. Недеогло	4,	621
Кинетика и спектральное распределение электролюминесценции структур пористый кремний-металл. Б.Я. Авербух, А.В. Андрианов, Л.В. Белжков, Д.Н. Горячев, Д.И. Ковалев, О.М. Сресели, И.Д. Ярошецкий	4,	627

Особенности оптического поглощения пленок люминесцирующего пористого кремния. Д.Г. Яркин, Е.А. Константинова, В.А. Тимошенко	4,	669
Фотодеградация пористого кремния при импульсном возбуждении. И.Х. Ксие, И.Н. Германенко, В.Ф. Гапоненко С.В. Воронин	4,	673
Обнаружение электролюминесценции локализованных носителей в одиночных разьединенных гетеропереходах II типа p-GaInAsSb/p-InAs. М.П. Михайлова, Г.Г. Зегря, К.Д. Мусеев, И.Н. Тимченко, Ю.П. Яковлев	4,	687
Получение и исследование пористого кремния в порошкообразной форме. А.В. Андрианов, Л.В. Беляков, Д.Н. Горячев, О.М. Сресели, И.Д. Ярошецкий	4,	733
Фотолюминесценция легированных разнесенных сверхрешеток GaAs/Al ₂ Ga ₁₋₂ As. В.И. Кадушкин, Е.Л. Шангина	5-6,	1051
Люминесцентные и структурные исследования монокристаллов GaSb, выращенных из нестехиометрических расплавов. Н.А. Берт, А.Е. Куницын, А.Г. Мильвидская, М.Г. Мильвидский, В.В. Чалдышев	5-6,	1116
Светоглушащие структуры Si:Er. Технология и физические свойства Обзор. Н.А. Соболев	7,	1153
Механизмы голубого излучения светодиодов на основе селенида цинка. Ю.Ф. Ваксман, А.Н. Краснов, Ю.Н. Пуртов	7,	1186
Функция пространственного распределения неравновесных электронно-дырочных пар при однофотонном возбуждении прямозонных полупроводников. П.Г. Лукашевич	7,	1253
Видимая и инфракрасная электролюминесценция пористого кремния. Л.В. Беляков, Д.Н. Горячев, Д.И. Ковалев, Ф. Коз, В. Петрова-Коз, О.М. Сресели, И.Д. Ярошецкий	7,	1288
Люминесцентные свойства квантовых точек InAs на вичинальной поверхности GaAs(100). Н.Н. Леденцов, М.В. Максимов, Г.Э. Цырлин, В.Н. Петров, Г.М. Гурьянов	7,	1295
Деградация фотолюминесценции пористого кремния под действием γ -облучения ⁶⁰ Со. Е.В. Астрова, В.В. Емцев, А.А. Лебедев, Д.И. Полоскин, А.Д. Ременюк, Ю.В. Рудь, В.Е. Харцеев	7,	1301
Изучение спектральной катодолуминесценции квантовых ям в гетероструктурах на основе A ^{III} B ^V с помощью акустооптического монохроматора. В.Л. Деноткин, С.М. Копылов, В.Г. Кригэль, О.А. Лабутин, А.В. Тарасов	7,	1329
Стимулированная лазером газофазная эпитаксия ZnSe на GaAs. А.В. Коваленко, А.Ю. Мекекечко	8,	1461
О фотолюминесценции пленок α -Si:H, легированных редкоземельными элементами. Ж. Атаев, В.А. Васильев, И.В. Елизаров, М.М. Мездрогина	9,	1537
Восстановление профиля изменения структуры полупроводника по толщине пластины из спектров фотолюминесценции. Ю.П. Маслбоев, С.В. Селищев, С.А. Терещенко	9,	1541
Излучательные комбинационные переходы через состояния связанных и свободных экситонов в односно деформированном теллуриде кадмия. М.В. Стриза, Н.И. Тарбаев, Г.А. Шепельский	9,	1611
Поглощение и фотолюминесценция свободного пористого кремния. Е.В. Астрова, А.А. Лебедев, А.Д. Ременюк, Ю.В. Рудь	9,	1649
Электролюминесценция варизонных полупроводников с омическими контактами. В.С. Соколовский	9,	1657
Кислород в люминесценции ZnSe(Te). Н.К. Морозова, Л.Д. Назарова, И.А. Каретников, В.Г. Галстян, Л.П. Гальчинецкий, В.Д. Рыжиков, О.Р. Голованова	9,	1678
Экспериментальное изучение влияния одноосного давления на эффекты горячих дырок в р-германии в продольных электрических полях. В.Г. Бельяг, А.Т. Далакян, В.Н. Тулупенко, В.А. Фирсов	10,	1764

Длинноволновое излучение при разогрете двумерных дырок продольным электрическим полем в квантовых ямах гетероструктур GaAs-AlGaAs. Л.Е. Воробьев, Д.В. Донецкий, А. Кастальский	10,	1771
Механизм увеличения интенсивности $f-f$ -люминесценции в полупроводниках. Г.Г. Зебря, В.Ф. Мастеров	10,	1893
Фотолюминесценция легированных множественных квантовых ям GaAs/Al ₂ Ga _{1-x} As при высоком уровне возбуждения. Б.Р. Варданян, А.Э. Юнович	11,	1976
О контуре спектра излучения электронно-дырочной плазмы при однофотонном возбуждении прямозонных полупроводников. П.Г. Лукашевич	11,	2002
Энергетическая оценка фотолитических центров в Ag ₂ O. В.А. Волл	11,	2071
Анализ спектров фотолюминесценции слоев GaAs, выращенных из Ga-Bi растворов-расплавов. А.Е. Куницын, С.В. Новиков, В.В. Чалдышев, М. Панек, Р. Пашкевич, В. Пашкевич, М. Тлакзала	11,	2088
Исследование пористого карбида кремния методами колебательной и люминесцентной спектроскопии. А.М. Данишевский, В.В. Шуман, А.Ю. Розачев, П.А. Иванов	12,	2122
Излучательная рекомбинация в германии, облученном реакторными нейтронами. В.А. Быковский, В.П. Доброго, Н.И. Долгих, В.В. Емцев, Е.Е. Халлер	12,	2236
3.5.4. Оптические свойства тонких пленок, поверхностей и структур, содержащих границы раздела (сверхрешетки, гетеропереходы и т. п.) (PACS 78.66)		
Процессы излучательной рекомбинации в двойных гетероструктурах InAsSbP/InAsSb/InAsSbP. М.С. Бреслер, О.Б. Гусев, М. Айдаралиев, Н.В. Зотова, С.А. Карандашев, Б.А. Матвеев, М.Н. Стусь, Г.Н. Талалакин	2,	219
Особенности фотоэффекта в резких изотипных N ⁺ -n ⁰ -n ⁺ -гетероструктурах. И.А. Жебулев, В.И. Корольков, Т.С. Табаров	3,	448
Оптические и электрические свойства сверхрешеток Фибоначчи PbS-C, полученных методом импульсного лазерного напыления. С.Ф. Мусигин, Л.Г. Бакуева, В.И. Ильин, О.В. Рабизо, Л.В. Шаронова	3,	474
Комбинационное рассеяние света и фотолюминесценция пористого кремния. В.А. Караванский, А.Н. Образцов	4,	582
Кинетика и спектральное распределение электролюминесценции структур пористый кремний-металл. В.Я. Авербух, А.В. Андрианов, Л.В. Беляков, Д.Н. Горячев, Д.И. Ковалев, О.М. Сресели, И.Д. Ярошецкий	4,	627
Резонансное рамановское рассеяние света на интерфейсных фонах в сверхрешетке GaAs/AlAs в сильном магнитном поле. Д.Н. Мирлин, А.А. Сиренко, Р. Плanelь	4,	636
Особенности оптического поглощения пленок люминесцирующего пористого кремния. Д.Г. Яркин, Е.А. Константинова, В.А. Тимошенко	4,	669
Фотодеградация пористого кремния при импульсном возбуждении. И.Х. Ксие, И.Н. Германенко, В.Ф. Гапоненко С.В. Воронин	4,	673
Обнаружение электролюминесценции локализованных носителей в одиночных разьединенных гетеропереходах II типа p-GaInAsSb/p-InAs. М.П. Михайлова, Г.Г. Зебря, К.Д. Мусеев, И.Н. Тимченко, Ю.П. Яковлев	4,	687
Получение и исследование пористого кремния в порошкообразной форме. А.В. Андрианов, Л.В. Беляков, Д.Н. Горячев, О.М. Сресели, И.Д. Ярошецкий	4,	733
Фотолюминесценция легированных разнесенных сверхрешеток GaAs/Al ₂ Ga _{1-x} As. В.И. Кадушкин, Е.Л. Шангина	5-6,	1051

Междупозонное поглощение света в квантовой яме полупроводника со сложной зонной структурой. Л.Е. Голуб, Е.Л. Иеченко, Р.Я. Расулов	5-6,	1093
Оптические явления при разогреве электронов в системе квантовых ям GaAs-AlGaAs продольным электрическим полем. Л.Е. Воробьев, С.Н. Данилов, Е.А. Зибик, Ю.В. Кочегаров, Д.А. Фирсов, Е. Тове, Д. Сан, А.А. Торопов, Т.В. Шубина	5-6,	1136
Люминесцентные свойства квантовых точек InAs на вращающейся поверхности GaAs(100). Н.Н. Леденцов, М.В. Максимов, Г.Э. Цырлин, В.Н. Петров, Г.М. Гурьянов	7,	1295
Деградация фотолюминесценции пористого кремния под действием γ -облучения ^{60}Co . Е.В. Астрова, В.В. Емцев, А.А. Лебедев, Д.И. Полоцкий, А.Д. Ременюк, Ю.В. Рудь, В.Е. Харццев	7,	1301
Стимулированная лазером газофазная эпитаксия ZnSe на GaAs. А.В. Коваленко, А.Ю. Мекекечко	8,	1461
Поглощение и фотолюминесценция свободного пористого кремния. Е.В. Астрова, А.А. Лебедев, А.Д. Ременюк, Ю.В. Рудь	9,	1649
Энергетическая релаксация горячих носителей в полупроводниковой короткопериодной сверхрешетке. О.Э. Грешневикова, С.В. Иванов, П.С. Копьев, В.Ю. Некрасов, В.Н. Трушин, И.Д. Ярошецкий	9,	1674
Стриминг и дальнее ИК излучение в двумерных дырочных структурах GaAs/AlGaAs. Ю.Л. Иванов, Г.В. Чураков, В.М. Устинов, А.Е. Жуков, А.Ю. Егоров	9,	1702
Длинноволновое излучение при разогреве двумерных дырок продольным электрическим полем в квантовых ямах гетероструктур GaAs-AlGaAs. Л.Е. Воробьев, Д.В. Донецкий, А. Кастальский	10,	1771
Фотолюминесценция легированных множественных квантовых ям GaAs/Al _x Ga _{1-x} As при высоком уровне возбуждения. Б.Р. Варданян, А.Э. Юнович	11,	1976
Особенности нелинейного отражения электромагнитных волн от многослойной структуры, связанные с разогревом электронного газа в легированном слое n-GaAs. А.И. Воронко, С.Е. Куменков, Г.Н. Шкерлин	11,	2024
Влияние поверхностного потенциала на комбинационное рассеяние света в фосфиде индия. А.Н. Образцов, А.А. Гоманюк, А.В. Миклуленок, Ф.С. Терра	11,	2082
Исследование пористого карбида кремния методами колебательной и люминесцентной спектроскопии. А.М. Данишевский, В.В. Шуман, А.Ю. Рогачев, П.А. Иванов	12,	2122
Переход металл-диэлектрик в сильно легированных p^+ -квантовых ямах на поверхности кремния n -типа. Н.Т. Баграев, Е.В. Владимирская, В.Э. Гасумянц, В.И. Кайданов, В.В. Кведер, Л.Е. Клячкин, А.М. Маляренко, Е.И. Чайкина, А.И. Шальнин	12,	2133
3.6. Эмиссия электронов и ионов. Ударная ионизация (PACS 79)		
Инжекция и полевая ионизация ловушек в монокристаллах MnGa_2Se_4 . Б.Г. Тагиев, О.Б. Тагиев, Н.Н. Мусаева	8,	1403
Самовыключение тока ударной ионизации в p - n -переходе. В.Н. Добровольский, А.В. Романов, С.Б. Грязнов	8,	1453
Эффект сегрегации ртути при импульсном лазерном отжиге $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$. М. Кузьма, М. Поцьяк, Е. Шерегий, В. Кемпник, М. Фарина, Р. Цят	8,	1483
Аналитическая модель распространения фронта ударной ионизации в диодной структуре большой площади. А.М. Минарский, П.В. Родин	8,	1506

Обнаружение фоточувствительности гетероконтактов полупроводник-зеленые листья. В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, В.Х. Шпунт	3,	438
Фотоэлектрические свойства контакта полупроводников с зелеными листьями. В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, В.Х. Шпунт	7,	1178
Исследование электрофизических свойств пленок α -C:H, перспективных для защитных покрытий электрофотографических носителей информации. В.Х. Кудоярова, В.Л. Аверьянов, А.В. Чернышев, М.Б. Цолов	9,	166

4.1. Методы получения и обработки полупроводниковых материалов (PACS 81)

Особенности деградации полуизолирующего арсенида галлия при термообработках. И.Ф. Айбазов, С.Б. Митрин, Б.Е. Саморуков	1,	162
Эпитаксиальный рост высокочистого GaAs методом МОС-гидридного осаждения с использованием криофильтрационной очистки арсина. В.В. Валяев, В.Л. Гуртовой, С.Ю. Шаповал, В.А. Киреев, Н.В. Смирнов	1,	175
Получение методом сублимации легированных пленок поликристаллического кремния. Д.А. Павлов, В.Г. Шенгуров, Д.В. Шенгуров, А.Ф. Хохлов	2,	286
Исследование кинетики термостимулированной релаксации объемного заряда в окисле SiO ₂ структур металл-окисел-полупроводник, облученных γ -квантами ⁶⁰ Со. Ю.В. Баринов, В.Н. Безбородов, В.В. Емельянов, В.С. Першенков	2,	323
Особенности выращивания кристаллов CdTe из расплава. О.А. Матвеев, А.И. Терентьев	2,	378
Зависимость параметров центров, образующих глубокие уровни во фториде кальция, выращенном на кремнии, от режима молекулярно-лучевой эпитаксии. Х. Альварес, Л.С. Берман, И.Н. Каримов	3,	405
Композиционные покрытия с матрицей из сульфида свинца для фотопроводящих слоев. В.С. Манько, В.А. Андреев, С.П. Чащин, И.Г. Хабибуллин, Э.А. Закирова	4,	718
Получение и исследование пористого кремния в порошкообразной форме. А.В. Андрианов, Л.В. Беляков, Д.Н. Горячев, О.М. Сресели, И.Д. Ярошецкий	4,	733
Проблемы микроэлектроники (1. Диффузия. 2. Дефектообразование. 3. Деградация). В.И. Соколов	5-6,	842
Исследование процесса роста эпитаксиальных слоев SiC при химическом осаждении из пара в системе CH ₃ SiCl ₃ -H ₂ . В.В. Зеленин, В.Г. Соловьев, С.М. Старобинец, С.Г. Конников, В.Е. Челноков	5-6,	1122
Глубокие центры в фотодиодах, полученных на основе In _z Ga _{1-z} As/InP методом газовой эпитаксии из металл-органических соединений. Т.В. Торчинская, В.И. Кушнеренко, Б.В. Щербина, К. Майнер	7,	1336
Стимулированная лазером газофазная эпитаксия ZnSe на GaAs. А.В. Коваленко, А.Ю. Мекекечко	8,	1461
Исследование силикатных стекол, легированных микрокристаллами сульфида-селенида кадмия, и оптических волноводов на их основе. С.Г. Конников, А.А. Липовский, Н.В. Никоноров, А.А. Ситникова, М.В. Харченко	8,	1473
Эффект сегрегации ртути при импульсном лазерном отжиге Cd _z Hg _{1-z} Te. М. Кузьма, М. Поцяск, Е. Шерегий, В. Кемпник, М. Фарина, Р. Пяж	8,	1483

Получение галькокопиритных пленок $\text{CuGa}_{1-x}\text{In}_x\text{Se}_2$ импульсным лазерным испарением. В.Ф. Гременок, В.В. Киндяк, Е.П. Заречная, А.С. Киндяк, И.А. Викторов, И.В. Боднар, Ю.В. Рудь	9,	1692
О механизме самоформирования наноразмерных структур пористого кремния при бестоковом водном травлении. М.Е. Компан, И.Ю. Шабанов	10,	1859
Наблюдение атомарной структуры пассивированной в водородной ЭЦР плазме поверхности Si (111) с помощью сканирующего туннельного микроскопа на воздухе. В.Л. Гуртовой, В.В. Дремов, В.А. Макаренко, С.Ю. Шаповал	10,	1888
Полупроводниковый карбид кремния — технология и приборы. Обзор. П.А. Иванов, В.Е. Челноков	11,	1921
Формирование структуры газочувствительных слоев диоксида олова, полученных реактивным магнетронным распылением. Р.М. Воццлова, Д.П. Димитров, Н.И. Долотов, А.Р. Кузьмин, А.В. Магин, В.А. Мошников, Ю.М. Таиров	11,	1987
Дефектообразование в поверхностной области кремния при его термическом окислении. В.П. Шаповалов, В.И. Грядун, А.Е. Королев	11,	1995
Энергетическая оценка фотолитических центров в Ag_2O . В.А. Вола	11,	2071
4.2. Полупроводниковые приборы (PACS 85)		
Примесный фоторезистор в режиме импульсного оптического гетеродинамирования. Г.А. Асланов, Т.М. Бурбаев, В.А. Курбатов, Н.А. Пенин	1,	9
Фотоэффект в эпитаксиальной $p^+ - n$ -структуре с n -областью переменной толщины и контактом туннельный окисел-металл. М.Г. Барышев, Б.С. Муравский, В.Н. Черный, И.Л. Яманов	1,	91
Токовая и временная зависимости остаточного напряжения во включенном состоянии фотонно-инжекционных импульсных коммутаторов. В.И. Корольков, Н.Ю. Орлов, А.В. Рожков, Ф.Ю. Солдатенков, М.Н. Степанова	3,	400
Влияние нейтронного и космического излучения на характеристики полевого транзистора с затвором Шоттки. С.В. Оболенский, Г.П. Павлов	3,	413
Поперечная фотоэдс в гетероэпитаксиальной структуре. Л.В. Шеховцов, А.В. Саченко, Ю.М. Шеварц	3,	566
Особенности оптимизации параметров и энергетические возможности термоэлектрических материалов на основе соединений кремния. В.К. Зайцев, М.И. Федоров	5-6,	946
Поверхностно-барьерные структуры $\text{CdSe}_x\text{Te}_{1-x}$ для солнечных элементов. А.М. Павелец, С.Ю. Павелец, Т.М. Сванидзе	5-6,	1061
Исследование диносторных структур на основе SiC-6H . А.Н. Андреев, А.М. Стрельчук, Н.С. Савкина, Ф.М. Снегов, В.Е. Челноков	5-6,	1083
Механизмы голубого излучения светодиодов на основе селенида цинка. Ю.Ф. Ваксман, А.Н. Краснов, Ю.Н. Пуртов	7,	1186
Свойства лавинных фотодиодов на основе гетероперехода Si-TiO_2 . А.П. Болтаев, Т.М. Бурбаев, Г.А. Калюжная, В.А. Курбатов, Т.И. Осина, Н.Н. Соловьев	7,	1220
Полевой транзистор на основе $6H\text{-SiC}$ с затвором в виде диода Шоттки. А.А. Лебедев, М.М. Аникин, А.Н. Кузнецов, М.Г. Растегаева, Н.С. Савкина, А.Л. Сырчин, В.Е. Челноков	7,	1231
Глубокие центры в фотодиодах, полученных на основе $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As/InP}$ методом газовой эпитаксии из металл-органических соединений. Т.В. Торчинская, В.И. Кушниренко, Б.В. Шербина, К. Майнер	7,	1336
Фотоэлектрические свойства контактов Ni-ZnSe . В.П. Магний, В.В. Мельник	8,	1468
Исследование силикатных стекол, легированных микрокристаллами сульфида-селенида кадмия, и оптических волноводов		

на их основе. С.Г. Конников, А.А. Липовский, Н.В. Никоноров, А.А. Ситникова, М.В. Харченко	8,	1473
Характеристики солнечных элементов при низких температурах. Е.Г. Гук, В.В. Шуман, А.С. Зубрилов	8,	1494
Поляризация излучения лазеров на основе двойной гетероструктуры InAsSb/InAsSbP. Т.Н. Данилова, О.Г. Ершов, Г.Г. Зегря, А.Н. Именков, М.В. Степанов, В.В. Шерстнев, Ю.П. Яковлев	9,	1604
Получение и исследование 6H-SiC эпитаксиально-диффузионных p-n-структур. А.А. Лебедев, А.Н. Андреев, А.А. Мальцев, М.Г. Растегаева, Н.С. Савкина, В.Е. Челноков	9,	1635
Предельная термоэлектрическая добротность полупроводниковых кристаллических материалов. Л.П. Булат, В.С. Загордонец	10,	1743
Фоточувствительность эпитаксиальной структуры p-GaAs/n-GaAs/p-Si. Л.А. Иванютин, Ф.М. Кацанов, С.Ю. Разлей, И.Н. Цыпленков	10,	1750
Кремниевый двухколлекторный n-p-n-тензотранзистор с ускоряющим электрическим полем в базе. С.И. Козловский	10,	1783
Короткозамкнутый полупроводниковый термомеханический преобразователь энергии. Л.П. Булат, В.С. Загордонец, В.Ю. Аркадьев	10,	1884
Полупроводниковый карбид кремния — технология и приборы. Обзор. П.А. Иванов, В.Е. Челноков	11,	1921
Промежуточное состояние управляемой четырехслойной p-n-p-n-структуры. Н.З. Вагидов, З.С. Грибницков, А.Н. Коршак, В.В. Митин	11,	1958
Трансформация спектра термостимулированного тока в n ⁺ -π-p-переходе при учете электрического поля в нейтральном слое π-области. Н.А. Урманов	11,	2053

5. Обзоры

Энергетический спектр трехмерных и двумерных дырок со снятым спиновым вырождением (исследование теллура). Обзор. В.А. Березовец, И.И. Фарбштейн	5-6,	965
Светоизлучающие структуры Si:Er. Технология и физические свойства. Обзор. Н.А. Соболев	7,	1153
Электродинамика двумерных электронных систем. Обзор. А.Я. Шик	8,	1345
Полупроводниковый карбид кремния — технология и приборы. Обзор. П.А. Иванов, В.Е. Челноков	11,	1921

6. Персоналии

Памяти Анатолия Робертовича Регеля (к 80-летию со дня рождения).	5-6,	769
Юрас Пожела (к 70-летию со дня рождения).	12,	2242
Борис Васильевич Царенков (к 65-летию со дня рождения).	12,	2244